T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ce₂GdCo₁₁B₄ BİLEŞİĞİNİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ ve MANYETOKALORİK ETKİNİN İNCELENMESİ

Tezi Hazırlayan Durmuş Serkan SÜTSEVER

Tezi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Nazmiye KERVAN

> Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

> > EYLÜL 2010 NEVŞEHİR

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ce₂GdCo₁₁B₄ BİLEŞİĞİNİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ ve MANYETOKALORİK ETKİNİN İNCELENMESİ

Tezi Hazırlayan Durmuş Serkan SÜTSEVER

Tezi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Nazmiye KERVAN

> Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

> > EYLÜL 2010 NEVŞEHİR

Yrd. Doç. Dr. Nazmiye KERVAN danışmanlığında **Durmuş Serkan SÜTSEVER** tarafından hazırlanan "**Ce₂GdCo₁₁B₄ Bileşiğinin Manyetik Özellikleri ve Manyetokalorik Etkinin İncelenmesi**" başlıklı bu çalışma, jürimiz tarafından Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

30/09/2010

JÜRİ:Başkan:Doç. Dr. Haşim YILMAZÜye:Yrd. Doç. Dr. Nazmiye KERVANÜye:Yrd. Doç. Dr. Sezen AKSÖZ

ONAY:

Bu tezin kabulü Enstitü Yönetim Kurulunun ?? / 1.1 /2010 tarih ve 2010/31-1 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

0.3. / 1.1 / 2010



TEŞEKKÜR

" $Ce_2GdCo_{11}B_4$ Bileşiğinin Manyetik Özellikleri ve Manyetokalorik Etkinin İncelenmesi" konulu tez çalışmamın seçiminde, yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında bana maddi manevi yardım ve katkılarını esirgemeyen değerli danışmanım sayın Yrd. Doç. Dr. Nazmiye KERVAN'a teşekkür ederim. Tez çalışmam için gerekli deneysel çalışmalarda ve kaynak araştırması için bana yardımlarını esirgemeyen değerli hocam sayın Doç. Dr. Selçuk KERVAN'a ve manyetik ölçümlerin yapılmasındaki yardımlarından dolayı sayın Doç. Dr. Hüseyin SÖZERİ'ye teşekkür ederim. Ayrıca tez çalışmam boyunca göstermiş olduğu sabır ve manevi desteklerinden dolayı eşim Elif SÜTSEVER' e ve çocuklarıma teşekkür ederim.

Ce₂GdCo₁₁B₄ BİLEŞİĞİNİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ ve MANYETOKALORİK ETKİNİN İNCELENMESİ

Durmuş Serkan SÜTSEVER Nevşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2010 Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nazmiye KERVAN

ÖZET

Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğinin manyetik özellikleri ve manyetokalorik etkinin incelenmesi, x-1şını kırınım ve mıknatıslanma ölçümleri ile incelenmiştir. Örnekler arkla-eritme yöntemiyle hazırlanmıştır. Bileşik, P6/mmm uzay grubundaki hekzagonal Ce₃Co₁₁B₄tipi yapıda kristalize olur. Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiği T_{C} =301 K'de ferrimanyetik düzendedir. T_{den} =40 K'de bir dengelenme sıcaklığı noktası bulunmuştur. Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğinin maksimum manyetik entropi değişimi | ΔS_{max} |, 0–5 T'lik bir alan değişimi için 0.306 Jkg⁻¹K⁻¹ bulunmuştur. Arrott çizimleri, Curie sıcaklığındaki manyetik faz geçişinin ikinci dereceden olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Manyetokalorik etki; manyetik malzemeler; manyetik özellikler.

MAGNETIC PROPERTIES AND MAGNETOCALORIC EFFECTS OF Ce₂GdCo₁₁B₄ COMPOUND

Durmuş Serkan SÜTSEVER Nevşehir University, Graduate School of Natural and Applied Science Department of Physics, September 2010 Thesis Supervisor: Assist. Prof. Nazmiye KERVAN

ABSTRACT

Magnetic properties and magnetocaloric effects of Ce₂GdCo₁₁B₄ compound were studied by means of x-ray diffraction and magnetization measurements. The sample was prepared by arc-melting. The compound crystallizes in a hexagonal Ce₃Co₁₁B₄-type structure with *P6/mmm* space group. Ce₂GdCo₁₁B₄ compound orders ferrimagnetically at T_{C} =301 K. A compensation point at $T_{comp.}$ =40 K was found. The maximum magnetic entropy change $|\Delta S_{max}|$ of Ce₂GdCo₁₁B₄ is 0.306 Jkg⁻¹K⁻¹ for a field change of 0–5 T. The Arrott plots show that magnetic phase transition at the Curie temperature is secondorder.

Keywords: Magnetocaloric effect; magnetic materials; magnetic properties

İÇİNDEKİLER

KABUL	VE ONAY	i
TEŞEKI	KÜR	ii
ÖZET		iii
ABSTR	ACT	iv
TABLO	LAR LİSTESİ	vii
ŞEKİLL	ER LİSTESİ	viii
1. BÖLU	ÜΜ	
GİRİŞ		1
2. BÖLU	ĴΜ	
MANYI	ETİK ÖZELLİKLER	
2.1.	Manyetizmanın Türleri	
2.2.	Diamanyetizma	
2.3.	Paramanyetizma	5
2.4.	Ferromanyetizma	6
2.5.	Antiferromanyetizma	
2.6.	Ferrimanyetizma	9
3. BÖLU	ĴΜ	
MANYI	ETOKALORİK ETKİ	11
3.1.	Manyetokalorik Etkinin Tanımı	11
3.2.	Termodinamik Kavramlar	14
3.2.1.	İç Enerji	14
3.2.2.	Entropi	
3.2.3.	Isı Kapasitesi	15
3.3.	Termodinamiğin Yasaları	
3.4.	Genel Termodinamik Yaklaşım	19
3.5.	İkinci Derece Faz Geçişi Teorisine Göre Manyetokalorik Etki	

3.6.	Manyetik Bir Malzeme İçin İstatistiksel ve Ortalama Alan Modeli				
3.7.	Entropi, Entropinin Değişimi ve Manyetokalorik Etki				
3.8.	Mıknatıslanma Ölçümleri ile Manyetokalorik Etkinin Belirlenmesi 47				
4. BÖLÜM					
DENEYSE	L YÖNTEMLER				
4.1.	Örneklerin Elde Edilmesi				
4.2.	X-ışını Toz Kırınımı				
4.2.1.	X-ışını Kırınımı				
4.2.2.	X-ışını Toz Kırınım Analizi				
4.2.3.	X-ışını Toz Kırınım Ölçümleri				
4.3.	Mıknatıslanma Ölçümleri				
5. BÖLÜM					
SONUÇ V	E TARTIŞMA				
KAYNAK	LAR				
ÖZGEÇMİ	Ş				

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 2.1.	Bazı diamanyetik maddelerin 300 K'deki manyetik alınganlıkları	5
Tablo 2.2.	Bazı paramanyetik maddelerin 300 K'deki manyetik alınganlıkları	6
Tablo 3.1.	Farklı bileşiklerin manyetokalorik etki değerleri	3

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1.	Ce ₃ Co ₁₁ B ₄ -tipi kristal yapı	2			
Şekil 2.1.	Bir diamanyet için $M(H)$ ve $\chi(T)$ eğrileri	4			
Şekil 2.2.	Paramanyetik bir malzemenin örgü yapısı	5			
Şekil 2.3.	Paramanyetik bir malzemenin mıknatıslanmasının sıcaklığa bağlı grat	fiği			
		5			
Şekil 2.4.	Paramanyetik bir malzemede manyetik alınganlığının tersinin sıcaklığ	ѯа			
	bağlı grafiği.	6			
Şekil 2.5.	Ferromanyetik bir malzemenin örgü yapısı	6			
Şekil 2.6.	Ferromanyetik bir malzemenin manyetik alınganlığının tersinin sıcak	lığa			
	bağlı değişimi	7			
Şekil 2.7.	$T_{\rm C}$ sıcaklığının altında doğal mıknatıslanmanın sıcaklıkla ilişkisi	7			
Şekil 2.8.	Ferromanyetik bir katıda doğal mıknatıslanmanın sıcaklıkla ilişkisi	7			
Şekil 2.9.	Manyetik alanı azalan bir ferromanyetik malzemenin mıknatıslanma				
	eğrisi (düz çizgi). Histerisis eğrisi (kesikli çizgi)	8			
Şekil 2.10.	Antiferromanyetik bir malzemenin manyetik alınganlığının tersinin,				
	sıcaklığa bağlı grafiği	9			
Şekil 2.11.	Antiferromanyetik bir malzemenin manyetik düzenlenişi	9			
Şekil 2.12.	Ferrimanyetik bir malzemenin örgü yapısı	9			
Şekil 2.13.	Ferrimanyetik bir malzeme için $T_{\rm C}$ sıcaklığının altındaki doğal				
	mıknatıslanma	. 10			
Şekil 2.14.	Ferrimanyetik bir malzeme için mıknatıslanma eğrileri	. 10			
Şekil 2.15.	Ferrimanyetik bir malzeme için $1/\chi - T$ grafiği	. 10			
Şekil 3.1.	Manyetokalorik etkinin şematik gösterimi	. 12			
Şekil 3.2.	İzotermal süreç ve adyabatik sürecin şematik gösterimi	. 12			
Şekil 3.3.	Bir ferromanyetik malzemede iki farklı H_1 ve H_2 ($H_2 > H_1$) alanında				
	manyetik entropinin sıcaklığa bağlı olarak değişimi	. 37			
Şekil 3.4.	(a) Isı kapasitesinin (b) Manyetik entropi değişiminin sıcaklığa bağlılığ	<u>,</u> 140			
Şekil 3.5.	Sıfır ve sıfırdan farklı manyetik alanda basit bir ferromanyetiğin topla	ım			
	entropisi S(T)'nin sıcaklığa bağlılığı	. 41			
Şekil 3.6.	(a) T/C 'nin (b) ΔT 'nin sıcaklığa bağlılığı	. 43			
Şekil 3.7.	EuS için farklı H manyetik alanlarında, manyetik entropi değişimi ΔS_M	(T,			

	<i>H</i>)'nin, manyetik entropi $S_M(T,H)$ 'nin ve toplam entropi $S(T,H)$ 'nin					
	sıcaklığa göre değişimi					
Şekil 3.8.	Gd ve ErAl_2 için $\Delta H = 50 kOe$ iken manyetik entropi değişimi ve					
	$\Delta S_M(T)$ 'nin sıcaklığa bağlılığı					
Şekil 3.9.	ErAl_2 ve Gd için ΔS_M 'de bağıl toplam hatanın sıcaklığa bağlılığı 51					
Şekil 4.1.	Örneklerin üretilmesinde kullanılan ark fırını 52					
Şekil 4.2.	X-ışınlarının bir kristalin düzlemlerinden kırınımı 53					
Şekil 4.3.	SQUID (Superconducting Quantum Interference Devices) manyetometre					
Şekil 4.4.	Mıknatıslanma ölçümlerinde kullanılan SQUID gerilimi - örnek konumu					
	grafiği 55					
Şekil 5.1.	Ce ₂ GdCo ₁₁ B ₄ bileşiğinin x-ışını toz kırınım analizi 56					
Şekil 5.2.	Ce ₂ GdCo ₁₁ B ₄ bileşiğine ait 1 T manyetik alan altındaki					
	mıknatıslanmanın sıcaklığa bağlı grafiği 57					
Şekil 5.3.	Ce2GdCo11B4 bileşiğinin 4 K'deki dış manyetik alana bağlı					
	mıknatıslanma grafiği 57					
Şekil 5.4.	Ce ₂ GdCo ₁₁ B ₄ bileşiğinin Curie sıcaklığı yakınlarında 5 T manyetik alana					
	kadar mıknatıslanma ölçümleri 58					
Şekil 5.5.	Çeşitli manyetik alanlarda $Ce_2GdCo_{11}B_4$ bileşiğinin manyetik entropi					
	değişimi					
Şekil 5.6.	Çeşitli sıcaklıklarda Ce2GdCo11B4 bileşiğinin Arrott çizimleri 59					

1. BÖLÜM

GİRİŞ

Manyetokalorik etki (MCE), ilk defa Alman bilim adamı Emil WARBURG tarafından 1881 yılında bir demir parçası üzerinde gözlenmiştir [1]. Daha sonra Debye [2] ve Giauque [3] adyabatik demanyatizasyon ile manyetik soğutmanın temel özelliklerini ve nasıl yapılacağını keşfetmişlerdir. Manyetik soğutma sistemi ilk defa 1933 yılında Nobel ödülü sahibi kimyacı William F. Giauque ve meslektaşı D.P. MacDougall tarafından üretilmiş ve bu sistemle 0.25 K değerine ulaşılmıştır [4]. Oda sıcaklığı civarında çalışabilen ilk manyetik soğutucu sistemi 1997 yılında, Iowa State Üniversitesi Ames Laboratuarında Prof. Karl A. Gschneidner tarafından üretilmiştir [5]. Sistemin ortaya çıkmasından sonra günümüze kadar manyetik soğutma sistemleri ve manyetokalorik etki konusuna olan ilgi hızla artmıştır.

Manyetokalorik etki kısaca, bir malzemeye manyetik alan uygulanmasıyla onun sıcaklığında meydana gelen değişimi ifade eder. Hayatımızın vazgeçilmez parçalarından olan soğutma sistemleri üzerine yapılan araştırma-geliştirme çalışmaları son yıllarda çok büyük hız kazanmıştır. Bu çalışmalarda en önemli konu verimi arttırma çabasıdır. Birçok bilim adamı tarafından yürütülen bu çalışmaların önemli bir kısmı uygun şartlar altında en verimli manyetokalorik etkiyi gösterecek malzemelerin elde edilmesi ve bu sayede manyetokalorik etki prensibiyle çalışan manyetik soğutma sistemlerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

R; Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy gibi nadir toprak elementi olmak üzere $R_3Co_{11}B_4$ bileşikleri, uzay grubu *P6/mmm* olan hekzagonal Ce₃Co₁₁B₄-tipi yapıda kristallenirler [6]. Bu bileşikler $R_{n+1}Co_{3n+5}B_{2n}$ ($n = 0, 1, 2, 3, \infty$) ailesindendir. $R_{n+1}Co_{3n+5}B_{2n}$ bileşiklerinin birim hücreleri, bir tane RCo_5 katmanı ve RCo_3B_2 birim hücresinden oluşan n tane katmanın c-ekseni boyunca alternatif olarak dizilmesi ile oluşmuştur. Şekil 1.1'de görüldüğü gibi Ce₃Co₁₁B₄-tipi yapıda (n=2), nadir toprak atomları iki konumda (1a, 2e), kobalt atomları üç farklı konumda (2c, 3g, 6i), bor atomları ise sadece bir konumda (4h) konumlanmıştır. $R_3Co_{11}B_4$ bileşikleri hakkında daha önce yapılan araştırmalar, Ce₃Co₁₁B₄ bileşiğinin ferromanyetik, Gd₃Co₁₁B₄ bileşiğinin ferrimanyetik olduğunu göstermiştir [7-10]. Curie sıcaklıkları (T_c), sırasıyla Ce₃Co₁₁B₄'de 265 K, Gd₃Co₁₁B₄'de ise 460 K'dir. Ayrıca Gd₃Co₁₁B₄ bileşiğinin 433 K'de dengelenme sıcaklığı (T_{den}) bulunmaktadır.



Şekil 1.1. Ce₃Co₁₁B₄-tipi kristal yapı.

Curie sıcaklığı oda sıcaklığı yakınlarında olan nadir toprak elementi içeren intermetalik bileşikler, manyetik soğutucularda kullanılabilecek manyetik malzemeler olabilirler. Bu tez çalışmasında, manyetik soğutucularda kullanılabilecek yeni manyetik malzemelerin bulunması amacı ile ferrimanyetik Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğinin Curie sıcaklığı (T_C =301) oda sıcaklığı yakınlarında olduğu için manyetik özellikleri ve manyetokalorik etkisi incelenmiştir.

2. BÖLÜM

MANYETİK ÖZELLİKLER

2.1. Manyetizmanın Türleri

Evrendeki bütün maddeler farklı manyetik özelliğe sahiptir. Manyetik alan içine konan maddeler mıknatıslanır. Birim hacim başına düşen toplam manyetik moment mıknatıslanma olarak ifade edilebilir. Maddelerin manyetik özellikleri manyetik alınganlık ölçümleri ile incelenir. Manyetik alınganlık (χ), mıknatıslanmanın (M) uygulanan manyetik alana (H) oranıdır. Manyetik alınganlık boyutsuz bir büyüklüktür. Manyetik alınganlık tayininde kullanılan yöntemler, Gouy terazisi, Faraday yöntemi ve Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) yöntemidir. Son iki yöntem mikro ölçek çalışmalar için uygundur. Manyetizma, maddenin atom ve kristal yapılarına bağlıdır. Manyetik özelliklerin büyüklükleri ve sıcaklığa bağımlılıkları farklıdır. Manyetizmanın türleri şunlardır:

- (a) Diamanyetizma
- (b) Paramanyetizma
- (c) Ferromanyetizma
- (d) Antiferromanyetizma
- (e) Ferrimanyetizma

2.2. Diamanyetizma

Diamanyetik bir madde, manyetik alan içinde yavaşça itilir. Bu durum, herhangi bir maddeye manyetik alan uygulanmasının madde içindeki elektronları ivmelendiren bir elektromotor kuvvet oluşmasına (Faraday yasası) neden olmasıyla açıklanabilir [11].

Diamanyetik malzemelerde atomlar net bir manyetik momente sahip değillerdir. Fakat malzemeye dışarıdan bir manyetik alan uygulandığında, yörüngedeki elektronlar bu

manyetik alanla etkileşir ve hızları değişir. Bu elektronlar, bir teldeki akım gibi düşünülebilir. Çembersel bir telde akım değiştirildiğinde bu akımı eski haline dönüştürmeye çalışan bir elektromotor kuvveti meydana gelir. Bu etki yörüngelerde dolaşan elektronlarda da meydana gelir ve dışarıdan uygulanan manyetik alana karşı başka bir manyetik alan oluşur. Bu durumda malzeme dışarıdan uygulanan manyetik alanı yavaşça itmiş olur. İşte bu tip manyetik malzemelere "diamanyetik" malzemeler denir.

Diamanyetik madde atomlarının daimi bir manyetik dipol momentleri yoktur. Ancak manyetik olarak etkin olan atomlarda, dış manyetik alan etkisi ile bir manyetik dipol momenti üretmek mümkündür. Bu şekilde üretilen manyetik momentin yönü, kendisini üreten alan ile ters yönde olmaktadır. Çekirdeğin etrafında zıt yönlerde fakat aynı süratle dolanan iki elektronlu klasik atom modelini düşünerek diamanyetizmayı bir ölçüde anlayabiliriz.

Diamanyetik malzemeler için manyetik alınganlık (χ) sıcaklığa çok az bir şekilde bağlıdır ve negatif değerler alır. Birim hacimde *N* atom bulunuyorsa,

$$\chi = \frac{M}{H} = \frac{N\mu}{H} = -\frac{NZe^2}{6mc^2} < r^2 >$$
(2.1)

şeklinde birim hacim başına diamanyetik alınganlık bulunabilir. İfadede r²'nin beklenen değeri kuantum mekaniğinde $\langle r^2 \rangle = \int \psi * r^2 \psi d^3 r$ eşitliği ile bulunabilir. Burada ψ elektrona ait dalga fonksiyonudur. Bir diamanyet için mıknatıslanma-manyetik alan M(H) ve alınganlık-sıcaklık χ (T) eğrileri şekil 2.1'deki gibi olur [11]. Bazı diamanyetik maddelerin 300 K'deki manyetik alınganlıkları tablo 2.1'de görülmektedir [5].



Şekil 2.1. Bir diamanyet için M(H) ve $\chi(T)$ eğrileri.

Diamanyetik Madde	Manyetik Alınganlık
Bizmut	-1.66×10 ⁻⁵
Bakır	-9.8×10 ⁻⁶
Elmas	-2.2×10 ⁻⁵
Altın	-3.6×10 ⁻⁵
Kurşun	-1.7×10 ⁻⁵
Civa	-2.9×10 ⁻⁵
Azot	-5.0×10 ⁻⁹
Gümüş	-2.6×10 ⁻⁵

Tablo 2.1. Bazı diamanyetik maddelerin 300 K'deki manyetik alınganlıkları.

2.3. Paramanyetizma

Paramanyetiklerde her bir atom veya iyon net bir manyetik momente sahiptir. Şekil 2.2'de görüldüğü gibi bu manyetik momentler dağınık olarak yönelmişlerdir.



Şekil 2.2. Paramanyetik bir malzemenin örgü yapısı.

Manyetik alan uygulanmasıyla manyetik momentlerin doğrultusu değişir ve alana paralel bir mıknatıslanma oluştuğu görülür. Şekil 2.3'de görüldüğü gibi bu mıknatıslanma miktarı yüksek sıcaklıklarda daha düşüktür. Artan sıcaklıkla birlikte alanın mıknatıslanmasındaki değişim daha lineer hale gelir. Mıknatıslanma 0 K'de sonsuz olur ve sıcaklığın artması ile azalır. Paramanyetik malzemelerin manyetik alınganlıkları oda sıcaklığında genelde 10⁻³ ile 10⁻⁵ arasındadır. Tablo 2.2'de bazı paramanyetik maddelerin 300 K'deki manyetik alınganlıkları verilmiştir [5].



Şekil 2.3. Paramanyetik bir malzemenin mıknatıslanmasının sıcaklığa bağlı grafiği.

Şekil 2.4'de görüldüğü gibi ideal durumlarda manyetik alınganlığın tersi sıcaklıkla birlikte lineer olarak değişir. Bu durum Curie yasası ile ifade edilir [12].



Şekil 2.4. Paramanyetik bir malzemede manyetik alınganlığının tersinin sıcaklığa bağlı grafiği.

Gerçek malzemelerde, özellikle düşük sıcaklıklarda Curie yasasından sapmalar görülür. Metallerde, iletim elektronları paramanyetik davranışa yol açabilir. Pauli paramanyetizması olarak adlandırılan bu durumda alınganlık hemen hemen sıcaklıktan bağımsızdır [12].

Paramanyetik Madde	Manyetik Alınganlık
Alüminyum	2.3×10 ⁻⁵
Kalsiyum	1.9×10 ⁻⁶
Krom	2.9×10^{-4}
Lityum	2.1×10^{-5}
Magnezyum	1.2×10^{-5}
Oksijen	2.1×10^{-4}
Platin	2.9×10^{-4}
Tungsten	6.8×10 ⁻⁵
Nayobiyum	2.6×10^{-4}

Tablo 2.2. Bazı paramanyetik maddelerin 300 K'deki manyetik alınganlıkları.

2.4. Ferromanyetizma

Ferromanyetik malzemelerin alt örgülerinde komşu atomların manyetik momentleri şekil 2.5'deki gibi paralel dizilmişlerdir. Manyetik momentlerin dizilimi uygulanan manyetik alanla aynı yönlüdür.



Şekil 2.5. Ferromanyetik bir malzemenin örgü yapısı.

Ferromanyetizma için yüksek sıcaklıkta manyetik alınganlığın tersinin sıcaklığa bağlı değişimi paramanyetikliğe benzer bir özellik taşır. Curie-Weiss yasası olarak adlandırılan bu durum Şekil 2.6'da gösterilmiştir [12].



Şekil 2.6. Ferromanyetik bir malzemenin manyetik alınganlığının tersinin sıcaklığa bağlı değişimi.

Paramanyetik malzemelerde 0 K sıcaklığında manyetik alınganlık sonsuz iken ferromanyetik malzemelerde manyetik alınganlık Cruie sıcaklığı olarak adlandırılan $T_{\rm C}$ karakteristik sıcaklığında sonsuz olur. Bu sıcaklığın altında, etkileşmeler termal uyarılmaların üstesinden gelir ve uygulanan manyetik alanın yokluğunda, şekil 2.7'de görülen doğal mıknatıslanma ($M_{\rm S}$) ortaya çıkar. Bu doğal mıknatıslanma, ayrı momentlerin hepsinin paralel olmasına uygun olan 0 K'de, şekil 2.8'de görüldüğü gibi maksimum değerine (M_0) ulaşır [12].



Şekil 2.7. T_C sıcaklığının altında doğal mıknatıslanmanın sıcaklıkla ilişkisi.



Şekil 2.8. Ferromanyetik bir katıda doğal mıknatıslanmanın sıcaklıkla ilişkisi.

Ferromanyetik malzemelerde, $T_{\rm C}$ sıcaklığının altında malzemelerin manyetik momentler toplamı sıfır olabilir. Yani malzemenin mıknatıslanması kaybolur. Bu durum malzemenin Weiss alanları olarak adlandırılan ve her bir alanda doğal mıknatıslanma atomlarının bulunduğu yeni alanların oluşmasının sonucudur. Doğal mıknatıslanma durumunda manyetik momentler, manyetik momentlerin toplamı sıfır olacak şekilde yön değiştirebilir. Manyetik alan uygulandığında ise manyetik momentlerin dağılımı değişebilir. Şekil 2.9'da makroskopik ölçüde ferromanyetik bir malzemede, uygulanan alan sonucunda ortaya çıkan güçlü mıknatıslanma görülmektedir.



Şekil 2.9. Manyetik alanı azalan bir ferromanyetik malzemenin mıknatıslanma eğrisi (düz çizgi). Histerisis eğrisi (kesikli çizgi).

Uygulanan manyetik alanın belli bir değerinden sonra mıknatıslanma doyuma ulaşır. Eğer uygulanan manyetik alan iki uç değer arasında $\pm H_C$ sürekli olarak değiştirilirse histerisis eğrisi adı verilen mıknatıslanma süreci tersinir değildir. Birçok teknolojik uygulamada şekil 2.9'daki bu eğriden yararlanılmaktadır.

2.4. Antiferromanyetizma

Antiferromanyetizma makroskopik açıdan paramanyetizmaya benzemektedir. Antiferromanyetik malzemelerin manyetik alınganlıkları pozitiftir. Antiferromanyetizma zayıf bir manyetizma türüdür. Manyetik alınganlığın tersinin, sıcaklığa bağlı grafiği Şekil 2.10'daki gibidir ve Neel sıcaklığı (T_N) olarak tabir edilen noktada minimuma ulaşır. Manyetik alınganlıktaki maksimum değer ise T_N sıcaklığının altında manyetik momentlerin antiparalel dizilimiyle görülür [12].



Şekil 2.10. Antiferromanyetik bir malzemenin manyetik alınganlığının tersinin, sıcaklığa bağlı grafiği.

Şekil 2.11'da görüldüğü gibi örgü dağılımı en basit durumda iki alt örgü içerisinde birbirlerinin mıknatıslanması ile eşit ve ters yönde olacak şekilde dağılır. Manyetik alanın yokluğunda mıknatıslanma sıfır olur. Manyetik momentlerin bu antiparalel dizilimi komşu atomların etkileşimleri sonucunda ortaya çıkar.



Şekil 2.11. Antiferromanyetik bir malzemenin manyetik düzenlenişi.

Sıcaklığın T_N sıcaklığının altına düşmesiyle, manyetik momentlerin antiferromanyetik dizilimi karşısında ortaya çıkan termal uyarılmadaki düşüşle birlikte manyetik alınganlık düşer. Yüksek sıcaklıklarda termal uyarılma etkisi, atomların etkileşmesi sonucunda ortaya çıkan etkiden fazladır. Bu durumda manyetik alınganlığın sıcaklığa bağlı değişimi paramanyetizmaya benzer şekilde görülür. Bu durum antiferromanyetik malzemelerdeki antiparalel alt örgülerin ortaya çıkardığı olaydır.

2.6. Ferrimanyetizma

Ferrimanyetizma mikroskobik açıdan antiferromanyetik malzemelere benzemektedir. Fakat iki alt örgü Şekil 2.12'de görüldüğü gibi aynı şekilde mıknatıslanmaz. İki alt örgü birbiriyle tam olarak örtüşmez.



Şekil 2.12. Ferrimanyetik bir malzemenin örgü yapısı.

İki alt örgünün birbiriyle tam olarak örtüşmemesi sonucunda $T_{\rm C}$ sıcaklığının altında şekil 2.13'de görüldüğü gibi bir doğal mıknatıslanma meydana gelir. Belirtilen sıcaklık aralığında ferrimanyetik malzemenin makroskopik özellikleri ferromanyetik malzemenin özelliklerine benzemektedir [12]. Şekil 2.14'de ise ferrimanyetik bir malzeme için $T_{\rm C}$ sıcaklığında, $T_{\rm C}$ sıcaklığının altında ve üstünde mıknatıslanma eğrileri verilmiştir.



Şekil 2.13. Ferrimanyetik bir malzeme için *T*_C sıcaklığının altındaki doğal mıknatıslanma.



Şekil 2.14. Ferrimanyetik bir malzeme için mıknatıslanma eğrileri.

Şekil 2.15'de görülen $1/\chi - T$ grafiğinde yüksek sıcaklıklardaki asimptot ferromanyetik malzemelerde olanın aksine genelde negatif değerlerde sıcaklık eksenini kesmektedir.



Şekil 2.15. Ferrimanyetik bir malzeme için $1/\chi - T$ grafiği.

3. BÖLÜM

MANYETOKALORİK ETKİ

3.1. Manyetokalorik Etkinin Tanımı

Manyetokalorik etki kısaca bir malzemeye manyetik alan uygulanmasıyla onun sıcaklığında meydana gelen değişimi ifade eder. Şekil 3.1'de görüldüğü gibi, manyetik bir malzemeye manyetik alan uygulandığında manyetokalorik malzemenin sıcaklığı artar dolayısıyla da çevresiyle ısı alış verişinde bulunur. Çevresi ile ısısal olarak yalıtılmış bir manyetik malzemeye güçlü bir manyetik alan uygulandığında, malzemenin düzensiz yönelmiş olan atomik manyetik momentleri aynı doğrultuda yönelirler ve bu durum sistemin daha düzenli bir yapı oluşturmasına neden olur. Sistemin termodinamik düzensizliğinin bir ölçüsü olarak tanımlanan entropisi azalır. Bunun sonucu olarak, azalan entropi dengesini yeniden eski haline getirmek için sistem sıcaklığını birkaç derece arttırır. Dolayısıyla malzeme ısı yayarak çevresini ısıtır. Manyetik alan uygulandığında düzenlenen manyetik dipoller manyetik alan ortadan kaldırıldığında yeniden gelişigüzel bir yönelim kazanır. Sistemin entropisi artar ve metal soğur. Şekil 3.1'de şematik olarak gösterilen bu fiziksel durum manyetokalorik etki olarak bilinir [13].

Manyetik alanın uygulanması izotermal süreç olarak isimlendirilirken, manyetik alanın ortadan kaldırılması ise adiyabatik süreç olarak isimlendirilir. Manyetokalorik etki bu iki temel süreç sonunda ortaya çıkar. Bu durum şekil 3.2.'de şematik olarak gösterilmiştir [13]. İzotermal süreçte malzemeye uygulanan manyetik alan ve sabit sıcaklık altında atomik spinler düzene girer ve manyetik entropi azalır. Adiyabatik süreçte ise, manyetik alan ortadan kaldırılır ve malzemenin sıcaklığı azalır.



Şekil 3.1. Manyetokalorik etkinin şematik gösterimi.



Şekil 3.2. İzotermal süreç ve adyabatik sürecin şematik gösterimi.

Tablo 3.1'de ise farklı bileşiklerin manyetokalorik etki değerleri görülmektedir [5]. Oda sıcaklığında en iyi manyetokalorik etki gösteren bileşiği elde etme çalışmaları hızla sürmektedir.

	$-\Delta S_M(mJcm^{-3}K^{-1})$		$\Delta T_{AD}(K)$		Yoğunluk	
Bileşik	T _C (K)	0-20 kOe	0-50 kOe	0-20 kOe	0-50 kOe	g/cm ³
TbCo ₂	236	26	48	1.9	3.6	9.087
DyCo ₂	142	101	128	4.5	6.3	10.013
HoCo ₂	83	112	203	4.0	8.8	10.172
ErCo ₂	37	300	331	3.0	7.4	10.343
Gd ₇ Pd ₃	323	22	57	3.0	8.5	8.707
Gd ₄ Bi ₃	332	15	27	2.2	4.2	10.073
Gd ₄ (Bi _{2.25} Sb _{0.75})	308	27	47	3.7	6.8	9.679
$\mathrm{Gd}_4(\mathrm{Bi}_{1.5}\mathrm{Sb}_{1.5})$	289	24	47	3.1	6.5	9.259
Gd ₄ (Bi _{0.75} Sb _{2.25})	273	26	49	3.2	6.4	8.834
Gd ₄ Sb ₃	265	29	55	3.2	6.4	8.414
Gd ₂ In	194	18.5	37	2.0	4.4	8.316
GdRu ₂ Ge ₂	34	23	56	1.5	4.0	9.459
GdPd ₂ Si	17	42	142	3.2	8.6	9.358
Mn _{1.95} Cr _{0.05} Sb	198	41	49			7.039
Mn ₃ GaC	160	-103	-109	-5.5	-5.5	6.933
Mn ₅ Si ₃	62.5	-5.1	-24.5			5.987
DyMn ₂ Ge ₂	40	85	108	5.2	7.2	8.033

Tablo 3.1. Farklı bileşiklerin manyetokalorik etki değerleri.

3.2. Termodinamik Kavramlar

3.2.1. İç Enerji

Klasik mekanikte, sistemin toplam enerjisinin (tüm parçacıkların kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı) sabit olduğu, yani zamanla değişmediği gösterilebilir. Fakat Joule deneyinde kütle azalırken, kütle ile ilgili potansiyel enerji de azalır. Sistemin enerjisinin azaldığı görülür. Eğer kaybolan enerjinin gittiği yer açıkça belirtilebilirse, enerji her zaman korunur kavramı anlaşılır.

Sistemin denge durumunda verilen bir değişiklik etkisi için yapılan iş miktarının ara süreçlere bağlı olmadığı gözlemlenmiştir. Bu gözlemin bir sonucu olarak sistemin iç enerjisi kavramı tanımlanabilir. İç enerji U ile gösterilir. Termal olarak yalıtılmış bir sistem bir durumdan diğer bir duruma W işi yapılarak getirilirse, iç enerjinin W'ye eşit olan bir ΔU miktarı kadar arttırıldığı söylenir. Potansiyel enerjideki herhangi bir kayıp iç enerjideki kazanç ile dengelenir.

Toplam yapılan iş, ilk durumdan son denge durumuna kadar seçilen yoldan bağımsızdır. Bunun sonucu olarak U niceliği sadece ilk ve son durumların bir fonksiyonudur. Bu yüzden U bir durum fonksiyonudur.

U'yu tamamen belirtmek için bir referans değeri (U_0) seçilir ve daha sonra herhangi bir diğer denge durumu için iç enerji $U=U_0+\Delta U$ eşitliği kullanılarak elde edilebilir. Referans enerjisinin seçimi keyfidir.

Termal olarak yalıtılmamış bir sistemin iç enerjisi değiştirilebilir. Çünkü sisteme enerji girebilir veya sistemden enerji çıkabilir. Enerjinin korunumu yasası gereği iç enerjideki değişim ilk değeri olan U_i 'den son değeri olan U_f 'ye kadar yazılırsa:

$$\Delta U = U_f - U_i = W - Q \tag{3.1}$$

olur. Burada Q sisteme eklenen ısı olarak tanımlanır ve W de sistem üzerine yapılan iştir. İç enerjideki değişim, sistem üzerinde yapılan iş ve eklenen ısının toplamıdır. Q ilave terimi termal olarak yalıtılmamış sistemlerde enerjinin korumu yasasını

sağlayabilmesi için ilave edilir. Termodinamiğin 1. yasası göz önüne alınırsa enerjinin korunacağını söyler.

3.2.2. Entropi

Geçen yüzyılın ortasında tersinir termodinamik işlemler üzerinde önemli bir keşif yapılmıştır. İç enerji gibi, bir cismin (veya bir sistemin) entropi adı verilen önemli başka bir durum fonksiyonuna daha sahip olduğu bulunmuştur. Bir sistem bir T sıcaklığında bir halden diğerine geçişte sonsuz küçük bir işlem süresinde dQ ısısını alırsa, dQ/T oranı bir S fonksiyonunun tam diferansiyeli olur. Bu fonksiyona entropi adı verilir ve buna göre bir sistemin entropisi aşağıdaki denklem ile bulunabilir:

$$S_2 - S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T}$$
(3.2)

Diferansiyeli dQ/T olan bir fonksiyonun varlığı doğanın çok önemli kanunlarından birisidir ve termodinamiğin ikinci kanunun bir temel parçasıdır. İlk kez Clausius tarafından hesaplara sokulan entropi bir sistemin iş yapma kapasitesini anlatan ve ölçülebilen bir niceliktir. Entropinin her zaman kullanılan birimleri, kalori/derece veya Joule/derece'dir. Entropinin değeri yalnız sistemin durumuna bağlı olup onun önceki geçmişine bağlı değildir [14].

3.2.3. Isı Kapasitesi

Fonon kavramı, kristallerin termal özelliklerinin özellikle de ısı sığasının belirlenmesi için kullanılabilir. Bu, özellikle uyarımların kuantum doğasının önemli olduğu düşük sıcaklıklarda ilgi çekicidir ve klasik sonuçlardan oldukça farklı davranış gösterir. Isı sığası olarak sabit hacimdeki ısı sığası anlaşılabilir. Deneysel yöntemler sabit basınçtaki ısı sığasını ölçer, ama sabit hacimdeki ısı sığası daha temel bir büyüklüktür. Termodinamik bir bağıntı $C_p - C_V = 9\alpha^2 BVT$ ilişkisini verir: burada α doğrusal genleşme katsayısı, V hacim ve B hacimsel modüldür. C_p ile C_V arasındaki fark genellikle küçüktür ve ihmal edilebilir. $T \rightarrow 0$ olduğunda α ve B sabitse, $C_p \rightarrow C_V$ olur. Sıcaklığı *T* ve enerjisi *U* olan bir maddenin sabit hacimdeki ısı sığası $C_V \equiv (\frac{\partial U}{\partial T})_V$ olarak tanımlanır. Bir kristalin ısı sığasına fononların katkısı örgü ısı sığası olarak isimlendirilir ve C_{lat} ile gösterilir.

3.3. Termodinamiğin Yasaları

<u>Termodinamiğin 1. yasası:</u> Eğer birbiriyle etkileşen parçacıklar içeren bir makroskopik sistem göz önüne alınırsa, bu sistemin korunum ilkesini sağlayan iyi tanımlanmış bir toplam enerjiye sahip olduğu söylenir. Bir termodinamik enerji fonksiyonunun varlığında, bu basit açıklama tarihsel gelişimden çok farklıdır. Çünkü termodinamikler, maddenin atomik teorisi kabul edilmeden önce geliştirilmiştir. Tarihsel olarak, bir makroskopik enerji korunum ilkesinin varlığı tamamen makroskopik gözlemler ile gösterilmiştir. Bu gözlemler Joseph Black, Benjamin Thompson, Robert Mayer ve James Joule tarafından yapılmıştır [15].

Yalıtılmış duvarlar ile çevrili bir sistem göz önüne alınsın. Böyle bir sistem termal olarak yalıtılmıştır. Bir adyabatik süreçte, sistemin durumu sadece sistem üzerine yapılan işle değiştirilir. Çok büyük gözlemsel gerçekten bilinir ki, termal olarak yalıtılmış bir sitemin durumunu değiştirmek için gerekli iş sadece sistemin ilk ve son durumlarına bağlıdır. Yani yapılan iş yoldan bağımsızdır. Bu şartlar altında yol bağımsızlığı gösterir ki, 1. durumdan 2. duruma bir değişim için bir U fonksiyonu tanımlanabilir. Termal olarak yalıtılmış sistem üzerindeki yapılan iş U'daki değişime eşittir:

$$W=U_2-U_1$$
 (adyabatik süreç) (3.3)

U niceliği sistemin iç enerjisi olarak adlandırılır. Denklem (3.3) ile tanımlanan iç enerji kütle merkezine göre ölçülür. *U* enerjisi bir durum fonksiyonuna örnektir, yani bu enerji makroskopik bir sistemin durumunu karakterize eder ve yoldan bağımsızdır.

Eğer sıfır enerjiye sahip bir referans durumu seçilirse, sistemin her bir durumu için U tek bir değere sahip olur. Çünkü adyabatik süreç için W yoldan bağımsızdır (W genellikle yola bağlıdır). Eğer değişim adyabatik olur ve sistemin çevresi ile etkileşmesine izin verilirse, genelde $\Delta U \neq W$ bulunurdu. Adyabatik süreçte ΔU ve W

arasındaki fark sıfırdır. Sistem ve çevresi arasındaki sıcaklık farkından dolayı sistem üzerine iş yaparak veya sistemi ısıtarak sistemin enerjisi arttırılabilir. Kapalı bir sistemin iç enerjisindeki değişim genelde şu şekilde verilir:

$$\Delta U = W - Q \qquad (termodinamiğin 1. yasası) \qquad (3.4)$$

Q niceliği ısıtmadan (Q>0) veya soğutmadan (Q<0) kaynaklanan sistem enerjisindeki değişimdir. W'de sistem üzerine yapılan iştir. Denklem (3.4) enerjinin korunum yasasını ifade eder ve "Termodinamiğin 1. Yasası" olarak bilinir. Bu denklem bir sistemin iç enerjisini değiştirmenin iki makroskopik yolu olduğunu söyler: sistem üzerine iş yapmak ve sistemi ısıtmak veya soğutmak.

Termodinamiğin 1. yasasının bir sonucu, W ve Q yola bağlı olmasına rağmen ΔU 'nun yoldan bağımsız olmasıdır. Bu bakış açısından, termodinamiğin 1. yasası enerjinin korunumunu ifade eder. Ancak, diğer bir bakış açısına göre, 1. yasa gösterir ki W ve Q yola bağlı olmalarına rağmen, onların toplamı yoldan bağımsızdır.

<u>Termodinamiğin 2. yasası:</u> Termodinamiğin 1. yasasının sonuçları şu ifadelerle özetlenebilir:

- i) Termal süreçte enerji korunur.
- ii) Isıtma, enerji transferinin bir biçimidir.

Dikkat edilmelidir ki bir sistemin iç enerjisi parçacıların kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı ile tanımlanabilir (Kütle merkezi hızının sıfır olduğu bir referans çerçevesinde).

Doğada meydana gelmeyen birçok süreç vardır. Fakat bu süreçlerin meydana gelmesi 1. yasa ile tutarlı olur. Örneğin, 1. yasa soğuk bir cisimden sıcak bir cisme eş zamanlı olarak enerji transferini yasaklamaz. Sistemlerin hesaba katılması gereken bir diğer özelliği entropidir.

Bir ideal gazın izotermal genleşmesi ne demektir? Bu süreç 2. yasayı bozar mı? Gaz genleştiğinde, piston üzerine iş yapar. Bu da gazın enerji kaybetmesine sebep olur. Süreç izotermal olduğu için, gaz enerjiyi soğurmalı ki gazın iç enerjisi sabit kalsın (Bir ideal gazın iç enerjisi sadece sıcaklığa bağlıdır.). Buradan,

$$\Delta U = Q - W = 0 \tag{3.5}$$

W=-Q olduğu görülür. Yani, gaz üzerine yapılan iş -W ve gaz tarafından yapılan iş Q'dur. Buradan, soğurulan enerji tamamen işe dönüşür sonucu çıkarılabilir. Ancak, bu dönüşüm gazın durumu baştan sona farklı olduğundan Kelvin ifadesini bozmaz. Bir makine yapmak için bu gaz kullanılamayabilir.

Deneysel gözlemlere dayanan 2. yasanın bir diğer ifadesi (enerji soğuk bir cisimden sıcak bir cisme eş-zamanlı olarak gidemez) şu şekilde ifade edilebilir:

2. yasanın Kelvin ve Clausius ifadeleri farklı görünür. Fakat her bir ifade diğerini ima eder. Bu yüzden bu ifadelerin sonuçları aynıdır.

2. yasanın çok özet bir yorumu (deneysel gözlemlere doğrudan dayanamaz fakat birçok kaynakta çok kullanılışlıdır) şu şekilde ifade edilebilir:

Durum fonksiyonuna yalıtılmış bir sistemde hiçbir zaman azalmayan ve entropi *S* olarak bilinen bir fonksiyon eklenir.

Mademki yalıtılmış bir sistemde entropi azalmıyor, o zaman dengede yalıtılmış bir sistem için entropinin maksimum olduğu sonucuna varılır. İlave terimi şu anlama gelir: iki sistemin entropisi sırasıyla S_A ve S_B ise, birleştirilmiş sistemin toplam entropisi $S_{toplam}=S_A+S_B$ olur.

Entropi açısından 2. yasanın ifadesi sadece yalıtılmış sistemlere (bir sistem yalıtılmış, sert ve su ve hava geçirmeyen duvarlar ile sarılmıştır) uygulanabilir. Normal sistemler çevresi ile enerji değiş-tokuşu yapabilir.

Eğer değişim tersinir ise, Clausius ifadesini bozmasından dolayı $\Delta S_{birleşik} > 0$ olmayacaktır. Bundan dolayı tek olasılık şu olur:

$$\Delta S_{birleşik} = 0 \qquad (tersinir süreç) \qquad (3.6)$$

Bu karışıklıktan kurtulmak için, sabit entropi sürecine eşdeğer olan tersinir terimi kullanılır. Tersinir olan bir süreç için koşul, kapalı bir sistemin toplam entropisinin sabit olmasını gerektirir.

<u>Termodinamiğin 3. yasası:</u> Tamamen termodinamik bağıntılar kullanılarak entropideki farklar hesaplanabilir. Termodinamiğin 3. yasası kullanılarak entropinin mutlak değeri belirlenebilir. Bu yasa şu şekilde ifade edilebilir:

$$\lim_{T \to 0} S = 0 \qquad (\text{termodinamiğin 3. yasası}) \qquad (3.7)$$

Bu eşitlik ilk kez deneysel gözlemlere dayanarak 1906'da Nernst tarafından sunulmuştur [15]. Termodinamik bağlamda 3. yasa sadece deneysel gözlemlerin bir sonucu olarak anlaşılabilir.

Üçüncü yasanın en önemli sonucu olarak, sıcaklık sıfıra yaklaştıkça tüm ısı kapasiteleri sıfıra gitmelidir. Sabit hacimdeki değişimler için:

$$S(T_2, V) - S(T_1, V) = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_v(T)}{T} dT$$
(3.8)

eşitliği bilinmektedir. Denklem 3.7'deki koşul $T_1 \rightarrow 0$ limitinde, denklem 3.8'deki integralin sonlu bir limite gitmesini söyler ve bundan dolayı $T \rightarrow 0$ giderken $C_v \rightarrow 0$ gider. Benzer olarak, $T \rightarrow 0$ giderken $C_p \rightarrow 0$ gider. Dikkat edilmelidir ki bu sonuçlara göre C_v ve C_p 'nin düşük sıcaklık davranışı sistemin doğasından bağımsızdır. Isı kapasitesinin bu düşük sıcaklık davranışı ilk kez 1910-1912'de deneysel olarak belirlenmiştir [15]. Bir klasik ideal gaz için ısı kapasitesi sabittir. Bundan dolayı, durumun termal denklemi yeterince düşük sıcaklıklarda uygulanabildiği için sona ermelidir.

3.4. Genel Termodinamik Yaklaşım

Manyetik malzemelerdeki manyetotermal etkiyi açıklamak için kullanılan termodinamik fonksiyonlar şunlardır: İç enerji U, serbest enerji F ve Gibbs serbest enerjisi G.

Sistemin *U* iç enerjisi; *S* entropi, *V* hacim ve *H* manyetik alanın bir fonksiyonu olarak [16-18]:

$$U = U(S, V, H) \tag{3.9}$$

seklinde veya S, V ve manyetik moment M'nin bir fonksiyonu olarak:

$$U = U(S, V, M) \tag{3.10}$$

şeklinde ifade edilebilir.

U iç enerjinin bu ifadelere karşılık gelen diferansiyeli

$$dU = TdS - pdV - MdH \tag{3.11}$$

$$dU = TdS - pdV - HdM \tag{3.12}$$

şeklinde gösterilebilir. Burada *p* basıncı, *T* mutlak sıcaklığı ifade eder.

Manyetik alan H, genellikle serbest enerji F ve Gibbs serbest enerjisi G de bir dış parametre olarak kullanılır.

T, V ve H'nin fonksiyonu olan F serbest enerji, sabit hacimli sistemler için kullanılır [16-18] ve

$$F = U - TS \tag{3.13}$$

şeklinde tanımlanır.

Serbest enerji F'nin diferansiyeli

$$dF = -SdT - pdV - MdH \tag{3.14}$$

şeklindedir.

G Gibbs serbest enerjisi *T*, *p* ve *H*ⁿnin fonksiyonudur ve sabit basınç altındaki sistemlerde kullanılır [16-18]:

$$G = U - TS + pV - MH \tag{3.15}$$

Diferansiyeli

$$dG = Vdp - SdT - MdH \tag{3.16}$$

şeklindedir.

Serbest enerji F için iç parametreler olan S, p ve M (genelleştirilmiş termodinamik nicelikler); T, V ve H dış değişkenlerine bağlıdır. Bu iç parametreler aşağıdaki eşitliklerle belirlenebilirler:

$$S(T, H, V) = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{H, V}$$
(3.17)

$$M(T,H,V) = -\left(\frac{\partial F}{\partial H}\right)_{V,T}$$
(3.18)

$$p(T,V,H) = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{H,T}$$
(3.19)

Aynı şekilde Gibbs serbest enerjisi için benzer eşitlikler de söz konusudur [16-18]:

$$S(T, H, p) = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{H, p}$$
(3.20)

$$M(T,H,p) = -\left(\frac{\partial G}{\partial H}\right)_{T,p}$$
(3.21)

$$V(T,H,p) = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,H}$$
(3.22)

Eğer Gibbs serbest enerjisinde manyetik moment M, manyetik alan H yerine dış değişken olarak seçilirse, o zaman

$$H = \left(\frac{\partial G}{\partial M}\right)_{T,p} \tag{3.23}$$

eşitliği sağlanır. Maxwell eşitlikleri olarak adlandırılan eşitlikler, (3.20) ve (3.21) eşitlikleri, (3.20) ve (3.22) eşitlikleri, (3.20) ve (3.23) eşitliklerinden elde edilebilir [16-19]:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_{T,p} = \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{H,p}$$
(3.24)

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T,H} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{H,p}$$
(3.25)

$$\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{T,p} = -\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{M,p}$$
(3.26)

x sabit parametre olmak üzere C ısı kapasitesi aşağıdaki şekilde tanımlanır [16-17]:

$$C_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_x \tag{3.27}$$

Burada δQ , dT sıcaklık değişimiyle sistemde meydana gelen ısı değişimini ifade eder. Termodinamiğin ikinci yasası kullanırsa [16-17]:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \tag{3.28}$$

ve ısı kapasitesi şu şekilde ifade edilebilir:

$$C_x = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_x \tag{3.29}$$

Termal geçiş katsayısı $\alpha_T(T, H, p)$ şu şekilde tanımlanabilir [16-17]:

$$\alpha_T(T,H,p) = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{H,p}$$
(3.30)

veya (3.25) eşitliği kullanırsa,

$$\alpha_T(T, H, p) = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_{T, H}$$
(3.31)

elde edilir.

Manyetik sistemin toplam entropisinin diferansiyeli T, H ve p'nin fonksiyonu olarak

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{H,p} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_{T,p} dH + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T,H} dp$$
(3.32)

şeklinde yazılabilir.

(3.24), (3.29), (3.31) ve (3.32) eşitlikleri kullanılarak adyabatik süreç için (dS = 0)

$$\frac{C_{H,p}}{T}dT + \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{H,p}dH - \alpha_T V dp = 0$$
(3.33)

eşitliği elde edilebilir. Burada $C_{H,p}$ sabit manyetik alan ve basınç altındaki ısı kapasitesidir.

Adyabatik-izobarik süreç altında(dp = 0, bu süreç, genellikle manyetokalorik deneylerde mümkündür) manyetik alanın (manyetokalorik etki) değişiminden dolayı sıcaklık değişimi (3.33) eşitliğinden

$$dT = -\frac{T}{C_{H,p}} \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{H,p} dH$$
(3.34)

şeklinde elde edilebilir.

Adyabatik-izokorik süreç (dV = 0) için ise V(T,H,p)'nın diferansiyeli

$$dV = \alpha_T V dT + \left(\frac{\partial V}{\partial H}\right)_{T,p} dH - V \kappa^{-1} dp$$
(3.35)

şekline sahiptir. Burada *k* hacimsel modülüdür:

$$\frac{1}{\kappa} = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T,H}$$
(3.36)

Adyabatik-izokorik süreç için (3.33) ve (3.35) eşitliklerinden yararlanarak:

$$\left\{\frac{C_{H,p}}{T} - \alpha_T^2 \kappa V\right\} dT + \left[\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{H,p} - \alpha_T \kappa \left(\frac{\partial V}{\partial H}\right)_{T,p}\right] dH = 0$$
(3.37)

ifadesi elde edilir. Kıvrık parantez içindeki ikinci terim küçük olduğu için ihmal edilebilir. Bu durumda manyetokalorik etki şu hale gelir:

$$dT = -\frac{T}{C_{H,p}} \left[\left(\frac{\partial M}{\partial T} \right)_{H,p} - \alpha_T \kappa \left(\frac{\partial V}{\partial H} \right)_{T,p} \right] dH$$
(3.38)

Burada ikinci terim sabit hacmin korunduğu sistemin, manyetik alandaki değişiklikten ortaya çıkan iç manyetik durumuyla ilgili değişiminden gelmektedir.

(3.32) eşitliği kullanılarak, dH alanı tarafından izobarik şartlar ve adyabatik manyetizasyon altında, manyetik malzemede ortaya çıkan dT manyetokalorik etki için genel açılım:

$$\frac{dT}{dH} = -\frac{(\partial S / \partial H)_{T,p}}{(\partial S / \partial T)_{H,p}}$$
(3.39)

şeklinde elde edilebilir.

Toplam entropi değişimi ise T, M ve p cinsinden şu şekilde yazılabilir:

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{M,p} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{T,p} dM + \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_{T,M} dp$$
(3.40)

(3.26), (3.29) ve (3.40) eşitliklerinden manyetizasyonun adyabatik-izobarik değişiminden ortaya çıkan manyetokalorik etki için açılım:
$$dT = \frac{T}{C_{M,p}} \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{M,p} dM$$
(3.41)

şeklinde elde edilebilir. (3.34) veya (3.41) eşitliklerinin integralleri alınarak, adyabatik manyetizasyon altında $\Delta T = T_2 - T_1$ sonlu sıcaklık değişimi hesaplanabilir.

(3.40) eşitliğinden izobarik şartlarda dT ve dM'yi birleştiren genel bir eşitlik elde edilebilir. (3.39) eşitliğine benzer şekilde:

$$\frac{dT}{dH} = -\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{T,p}}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{M,p}}$$
(3.42)

elde edilebilir.

Bu kesimde sistem içerisinde ve sistemdeki mikroskobik etkileşimlerde varsayımlar yapılmadan genel termodinamik eşitliklerinden bahsedildi. Sistemin manyetokalorik etkilerine daha fazla yoğunlaşmak için *F* veya *G* termodinamik fonksiyonlarla ilgili bazı varsayımlara ihtiyaç duyulur.

F ve G, bağımsız değişkenler olarak sayılan M ve V veya p iç parametrelerine bağlı denge durumunda olmayan $\Phi(T, H, M, p, V)$ termodinamik potansiyeli kullanılarak oluşturulabilir. G denge Gibbs serbest enerjisi veya F denge serbest enerjisini elde etmek için, Φ ifadesi M ve V veya M ve p'lere göre minimum yapılır:

$$G(T, H, p) = \min_{M, V} \Phi(T, H, M, p, V)$$
(3.43)

$$F(T,H,V) = \min_{M,p} \Phi(T,H,M,p,V)$$
(3.44)

O zaman, termodinamik eşitlikler olan (3.17), (3.18), (3.19), (3.20), (3.21), (3.22) ve (3.23) eşitliklerinden faydalanarak bir sistemin denge iç parametreleri elde edilebilir. Sistemin denge durumunda olmayan Φ potansiyeli simetri ve/veya mikroskobik yaklaşımla belirlenebilir.

3.5. İkinci Derece Faz Geçişi Teorisine Göre Manyetokalorik Etki

Belov, ikinci derece faz geçişlerinin Landau teorisini ikinci derece manyetik faz geçişlerine uyarlamıştır [20]. Özellikle herhangi bir geçiş, T_C Curie sıcaklığı noktasında

bir ferromanyetikte yer alır. Belov'un teorisine göre Curie noktasının yakınında bir ferromanyetiğin potansiyeli, sıralı parametrenin kuvvet serisi olarak açılabilir, daha sonrakiler Curie noktasında sıfır olur. Manyetik sistemlerde sıralı parametreler mıknatıslanmadır ve tekli alan için izotropik ferromanyetiktir. Manyetik alan bulunmadığı durumda bu açılım tekli alan için

$$\Phi = \Phi_0 + \frac{\alpha}{2}M^2 + \frac{\beta}{4}M^4 + \dots$$
(3.45)

şeklini alır. Burada Φ_0 manyetizasyonla ilgili olmayan potansiyelin bir kısmıdır. Denklemde *M* mıknatıslanmadır ve α ile β termodinamik katsayılardır.

 α ' nın sıfır olduğu Curie noktası civarında

$$\alpha = \alpha_{\theta} (T - T_C) + \dots \tag{3.46}$$

şeklinde açılabilir. α katsayısı, T_C sıcaklığının altında negatif, üzerinde pozitiftir. T_C sıcaklığı civarında β katsayısı, $T: \beta = \beta(T_C)$ ifadesine bağlı değildir. Φ potansiyelinin minimum durumundan ($d\Phi/dM = 0$) doğal mıknatıslanma M_s hesaplanabilir:

$$M_s^2 = -\frac{\alpha}{\beta} = -\frac{\alpha_{\theta}(T - T_C)}{\beta}$$
(3.47)

 $M_{\rm s}$ (3.45) eşitliğinde yerine koyulursa termodinamik potansiyel Φ 'nin denge değeri elde edilir.

Manyetoelastik etki hesaba katılırsa manyetik alan H içerisindeki ferromanyetik için Φ potansiyeli şu şekilde yazılabilir:

$$\Phi = \Phi_0 + \frac{\alpha}{2}M^2 + \frac{\beta}{4}M^4 + \frac{1}{2}\gamma M^2 p - HM$$
(3.48)

Bu eşitlik M'ye göre minimum yapılırsa, Curie noktası civarında mıknatıslanma [20]:

$$(\alpha + \gamma p)M + \beta M^3 = H \tag{3.49}$$

şeklinde bulunur.

 γ katsayısı manyetoelastik etkiyi tanımlar ve aşağıdaki eşitlik ile basınç altında Curie sıcaklık değişimiyle ilgilidir (T_C sıcaklığında ($a + \gamma p$) = 0 şartından hareketle):

$$\frac{\Delta T_c}{\Delta p} = -\frac{\gamma}{\alpha_{\theta}} \tag{3.50}$$

(3.49) eşitliği kullanılarak $(\partial H/\partial T)_M$ türevi hesaplanabilir ve (3.41) eşitliğinde yerine yazabilir. Bu, Curie sıcaklığı yakınında manyetokalorik etkinin değerini verir:

$$dT = \frac{1}{2} \frac{\alpha_{\theta} T}{C_{M,p}} dM^2$$
(3.51)

(3.51) eşitliğinden de görüldüğü gibi, sıcaklık değişimi manyetik alan değişimindeki mıknatıslanmanın karesiyle orantılıdır. $\Delta T = k\Delta M^2$ ifadesinde k orantı katsayısıdır. Bu sonuç ve (3.49) eşitliği kullanırsa bir ferromanyetikte Curie sıcaklığına bağlı manyetokalorik etki alanının eşitliği [20]:

$$\frac{\alpha + \gamma p}{k^{1/2}} + \frac{\beta}{k^{3/2}} \Delta T = \frac{H}{\Delta T^{1/2}}$$
(3.52)

şeklinde elde edilebilir.

3.6. Manyetik Bir Malzeme İçin İstatistiksel ve Ortalama Alan Modeli

Bir sistemin istatistiksel toplamı veya bölüşüm fonksiyonu [19,21]

$$Z = \sum_{n} \exp\left[-E_{n}/(k_{\beta}T)\right] = S_{p}\left(\exp\left[-\hat{H}/k_{B}T\right]\right)$$
(3.53)

şeklinde belirlenebilir. Burada \hat{H} sistemin Hamiltonyeni, E_n özdeğerleri ve k_B Boltzmann sabitidir. Z değeri bilinirse, sistemin serbest enerjisi [19,21]:

$$\mathbf{F} = \mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T} \ln \mathbf{Z} \tag{3.54}$$

şeklinde yazılır ve (3.17), (3.18) ve (3.19) eşitlikleri kullanılarak sistemin iç parametleri hesaplanabilir.

Eğer manyetik sistem paramanyetik ise, bir atom için Hamiltonyen şu şekilde olur:

$$\hat{H} = -\hat{M}_J \vec{H}$$
(3.55)

Burada \vec{H} manyetik alan vektörü, $\hat{M}_J = g_J \mu_B \hat{J}$ manyetik moment operatörüdür. Bu durumda bir atom için bölüşüm fonksiyonu şu şekli alır:

$$Z_J(x) = \sum_{m=-J}^{J} \exp\left[\frac{mx}{J}\right]$$
(3.56)

Burada *x*,

$$x = \frac{M_J H}{k_B T} \tag{3.57}$$

şeklinde tanımlanır.

 g_j atomun g- faktörü, J toplam açısal momentum kuantum sayısı, m = J, J - I,..., -J ve $M_J = g\mu_B J$ bir atomun manyetik momentidir.

(3.56) eşitliğinin sadeleştirilmiş şeklinden şu eşitlik elde edilir:

$$Z_J(x) = \frac{\sinh\left(\frac{2J+1}{2J}x\right)}{\sinh\left(\frac{1}{2J}x\right)}$$
(3.58)

Sistemin manyetik serbest enerjisi (malzemenin manyetik alt sistemi ile ilgili olan enerjinin kısmı) *N* manyetik atomdan oluşursa

$$F_M = -k_B T \ln(Z_J(x))^N \tag{3.59}$$

şekline sahiptir. Bu eşitliği kullanarak, (3.18) eşitliği ile sistemin manyetik momenti hesaplanabilir:

$$M = NM_J B_J(x) \tag{3.60}$$

Burada $B_J(x)$ Brillouin fonksiyonudur:

$$B(J,x) = \frac{2J+1}{2J} Coth \frac{(2J+1)x}{2J} - \frac{1}{2J} Coth \left(\frac{x}{2J}\right)$$
(3.61)

 $x \ll 1$ için (bu durum yüksek sıcaklık bölgesi için karakteristiktir ve genellikle manyetikten paramanyetik duruma dönüşüm sıcaklığı yakınlarında göz önünde bulundurulur) $B_J(x)$ şu şekilde açılabilir:

$$B_J(x) = \frac{J+1}{3J}x - \frac{((J+1)^2 + J^2)(J+1)}{90J^2}x^3 + \dots$$
(3.62)

Paramanyetiklerin bu açılımı Curie yasasını açıklamada kullanılır:

$$M = \frac{C_J}{T}H \tag{3.63}$$

burada $C_J = N\mu_B^2 g_J^2 J (J+1)/3k_B$ Curie sabitidir.

(3.34) eşitliğinden bir paramanyetiğin manyetokalorik etkisi elde edilebilir:

$$dT = \frac{T}{2C_{H,p}C_J} \delta(M^2)_{T,p}$$
(3.64)

Burada $\delta(M^2)_{T,p} = (\partial M^2 / \partial H)_{T,p} dH$ mıknatıslanmanın karesinin izotermobarik değişimdir.

Bir izotropik ferromanyetiğin Hamiltonyeni

$$\hat{H} = -\sum_{i>j} M_{ij} (\hat{J}_i \, \hat{J}_j) - \sum_i \hat{M}_{i,j} \, \vec{H}$$
(3.65)

şekline sahiptir.

Burada M_{ij} , *i* ve *j* iyonları arasına etkileşme için değişim integralidir ve J_i iyonun toplam açısal momentum operatörüdür. Ortalama alan yaklaşımında (MFA), (3.65) eşitliği

$$\hat{H} = -\sum_{i>j} M_{ex} z J(\hat{J}_j \vec{n}) - \sum_i \hat{M}_{i,j} \vec{H}$$
(3.66)

şeklini alır.

Burada z en yakın komşu manyetik iyonlarının sayısı, J toplam açısal momentum kuantum sayısı, n iyonun toplam manyetik momentinin yönünü belirleyen birim vektör ve M_{ex} değişim integrali (en yakın komşuların her çifti için değiş tokuş etkileşmesinin M_{ex} ile aynı değere sahip olduğu MFA'da desteklenir) MFA'da değiş tokuş etkileşmesi, etkin değiş tokuş alanı H_m (moleküler alan) ile yer değiştirmiştir:

$$H_{\rm m} = wM \tag{3.67}$$

burada w moleküler alan katsayısıdır ve değiş tokuş integraline bağlıdır. Moleküler alan dış manyetik alana eklenir ve (2.57) eşitliği

$$x = \frac{M_J(H + wM)}{k_B T}$$
(3.68)

şeklini alır. Doğal mıknatıslanma M_s 'nin alana ve sıcaklığa bağlılığı, (3.60) ve (3.68) eşitliklerinin birlikte çözümü ile bulunabilir.

 $T > T_C$ ve H = 0 için eşitlikler yalnız $M_s = 0$ için tek çözüme sahiptir. T_C 'nin altındaki sıcaklık için, doğal manyetik momente uygun kararlı sıfırdan farklı bir çözüm

x << 1 iken
$$M_s^2 = M_{s0}^2 \frac{10(J+1)^2}{3((J+1)^2 + J^2)} \left(1 - \frac{T}{T_c}\right)$$
 (3.69)

şeklinde olur. Burada $M_{s0} = NM_i$, T=0 K'deki doğal manyetik momenttir.

 $x \ll 1$ olduğu paramanyetik bölgede, (3.62) eşitliğindeki yalnız ilk terim göz önüne alınır ve manyetizasyon eşitliği Curie-Weiss yasasının şeklini alır:

$$M = \frac{C_J H}{T - T_C} \tag{3.70}$$

Burada Curie sıcaklığı T_C , şu şekilde yazılabilir:

$$T_{C} = \frac{NM_{eff}^{2}w}{3k_{B}} = \frac{2(J+1)}{3Jk_{B}}zM_{ex}$$
(3.71)

ve $M_{eff} = g_J (J(J+1))^{1/2} \mu_B$ bir atomun etkin manyetik momentidir. (3.34) eşitliği kullanılarak, paramanyetik bölgedeki ($T > T_C$) (3.64) eşitliğiyle aynı şekle sahip bir ferromanyetiğin manyetokalorik etkisi için bir eşitlik elde edilebilir. $T < T_C$ sıcaklığında ve sıfırdan farklı manyetik alanda bulunan bir ferromanyetik için (3.64) eşitliğinden daha karmaşık bir sonuç ortaya çıkar [22]:

$$dT = \frac{T_C}{2C_{H,p}C_J} \delta(M^2)_{T,p}$$
(3.72)

Yukarıda, manyetik sistemin kuantum mekaniksel yaklaşımı yapılmıştır. Klasik durumda uzayın, rastgele yönelmiş olan μ manyetik momentli parçacıklardan oluştuğu kabul edilmektedir. Herhangi bir sistem için manyetik moment formülü şu şekildedir [21]:

$$M = N\mu L(x) \tag{3.73}$$

burada

$$L(x) = \coth x - \frac{1}{x} \tag{3.74}$$

Langevin fonksiyonu olarak adlandırılır ve x; paramanyetikler için

$$x = \frac{\mu H}{k_B T} \tag{3.75}$$

ferromanyetikler için

$$x = \frac{\mu(H + wM)}{k_B T} \tag{3.76}$$

şeklindedir.

 $x \ll l$ için L(x) açılımı şu şekilde olabilir

$$L(x) = \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \dots$$
(3.77)

Bu durumda (3.63), (3.64), (3.70) ve (3.72) eşitlikleri

$$C_J = N\mu_{et}^2 / 3k_B \tag{3.78}$$

Curie katsayısı ile geçerlidir ve Curie sıcaklığı

$$T_C = \frac{N\mu^2 w}{3k_B} \tag{3.79}$$

şeklindedir.

3.7. Entropi, Entropinin Değişimi ve Manyetokalorik Etki

Bir manyetik malzemenin önemli karakteristikleri, malzemenin toplam entropisi S ve manyetik alt dizenin entropisi S_M (manyetik entropi)'dir. Entropi manyetik alan, sıcaklık ve diğer termodinamik parametlerinin değişimi ile değişebilir. Manyetik entropi ve değişimi, manyetokalorik etki ve ısı kapasitesine manyetik katkı ile yakından ilgilidir. Manyetik entropi değişimi, manyetik soğutucuların soğutma kapasitesi ve benzeri karakteristiklerini belirlemek için kullanılır.

Manyetik malzemenin toplam entropisi sabit basınç altında genel olarak [23]

$$S(H,T) = S_M(H,T) + S_1(H,T) + S_e(H,T)$$
 (3.80)

şeklinde açıklanabilir. Burada S_M manyetik entropidir, S_1 örgünün ve S_e elektronun toplam entropiye katkılarıdır. Bu formül nadir manyetik malzemeler için geçerlidir. Fakat 3*d* elektronlarının bulunduğu 3d geçiş malzemelerin durumunda alanın iletkenliğe katkıları *s*- ve *p*- elektronlarının katkıları ile karşılaştırılır. Bu durumda örgü entropisinin ayrımı yalnız elektron-fonon etkileşmesi hesaba katılmadığında mümkün olur.

Genelde, üç katkının hepsi sıcaklık ve manyetik alana bağlıdır ve açıkça ayrılmayabilir. Bu durum, elektronik ısı kapasitesi katsayısı a_e 'nin manyetik alanın etkisiyle veya manyetik, yapı ve elektronik faz geçişleri durumundaki düşük sıcaklık bölgesi durumunda özellikle zordur. Örneğin Sc [24], CeB₆, ve CeCu₂Si₂ [25] ve UBe₁₃ [26] gibi yüksek a_e değerine sahip malzemelerde 10 *K* altındaki sıcaklıklarda elektronik entropi ve elektronik ısı kapasitesi, sıcaklık ve manyetik alana bağlı olarak lineer olmayan bir değişim gösterir. Ancak ilk yaklaşımda entropinin örgü ve elektronik kısmının sadece sıcaklığa bağlı olduğu düşünülebilir. Manyetik alana bağlı tüm katkılar (manyetik alt sistemin herhangi değişimimden) $S_M(H,T)$ ile (3.80) eşitliğinde entropinin toplam değerinde görülür.

Örgü entropisi Debye interpolasyon formülü ile hesaplanabilir [27]:

$$S_{l} = n_{a}R\left[-3\ln(1-e^{T_{D}/T}) + 12\left(\frac{T}{T_{D}}\right)^{3}\int_{0}^{T_{D}/T}\frac{x^{3}dx}{e^{x}-1}\right]$$
(3.81)

burada *R* gaz sabiti, T_D Debye sıcaklığı ve n_a 'da bir maddede molekül başına atomların sayısıdır. (3.81) eşitliğinden, S_1 'nin T_D arttırıldığında azaldığı görülür. Elektron entropisi standart bağlantı ile hesaplanabilir:

$$S_e = a_e T \tag{3.82}$$

burada a_e elektronik ısı kapasite katsayısıdır.

(3.80) ve (3.29) eşitlikleri kullanılarak, manyetik bir malzemenin toplam ısı kapasitesi

$$C_{H} = C'_{H} + C_{1} + C_{e} \tag{3.83}$$

şeklinde verilebilir. Burada C'_H , C_l ve C_e değerleri sırasıyla manyetik, örgü ve elektron katkılarıdır.

Manyetik altsistemin 1s1 kapasitesi (manyetik 1s1 kapasite) $C'_{H}(T, H)$, (3.29) eşitliği kullanılarak

$$C'_{H}(T,H) = T \left(\frac{\partial S_{M}(T,H)}{\partial T} \right)_{H}$$
(3.84)

şeklinde tanımlanabilir. Buradaki H alt indisi ısı kapasitenin sabit manyetik alan içerisinde hesaplandığını ifade etmektedir.

Örgü ve iletim elektronlarının toplam ısı kapasitesine katkısının manyetokalorik etkiyi azaltan ek bir ısı ile olabileceğine ((3.34) eşitliği) dikkat edilmelidir.

N manyetik atoma sahip bir sistem için, *J* bir atomun toplam açısal momentum kuantum sayısı olmak üzere manyetik entropi S_M , (3.17) ve (3.59) eşitlikleri kullanılarak [21]:

$$S_{M}(T,H) = Nk_{B}\left[\ln\frac{\sinh\left(\frac{2J+1}{2J}x\right)}{\sinh\left(\frac{1}{2J}x\right)} - xB_{J}(x)\right]$$
(3.85)

şeklinde elde edilebilir.

Yüksek sıcaklık ve düşük alan ($x \ll 1$) durumunda (3.59) eşitliğindeki istatistiksel toplam x'in kuvvet serisi olarak açılabilir. Bu sayede paramanyetiğin S_M hesaplaması için şu eşitlik elde edilir [18]:

$$S_{M}(T,H) = Nk_{B} \left[\ln(2J+1) - \frac{1}{2} \frac{C_{J}H^{2}}{T^{2}} \right]$$
(3.86)

burada C_J Curie sabitidir ve Curie sıcaklığı üzerinde bir ferromanyetiğin S_M 'si için ifade

$$S_{M}(T,H) = Nk_{B} \left[\ln(2J+1) - \frac{1}{2} \frac{C_{J}H^{2}}{(T-T_{C})^{2}} \right]$$
(3.87)

şeklindedir. Maksimum manyetik entropi değerine $T \rightarrow \infty$ ve H = 0 şartlarının sağlandığı durumda ulaşılır. (3.86) ve (3.87) eşitliklerine göre, toplam açısal momentum kuantum sayısı *J* olan manyetik atomların her molündeki maksimum manyetik entropi değeri şuna eşittir:

$$S_{M} = N_{A}k_{B}\ln(2J+1) = R\ln(2J+1)$$
 (3.88)

burada N_A Avagadro sayısıdır.

İzobarik şartlar altında manyetik alan ve sıcaklığın değişimiyle bir manyetik malzemenin S(H,T) entropisinin değiştiği düşünülsün. (3.60), (3.29) eşitlikleri ve manyetik alan üzerine S_1 ve S_e nın bağımsızlığı hakkındaki düşüncelere göre S(H,T) nin toplam diferansiyeli

$$dS(H,T) = \frac{C_1(T)}{T}dT + \frac{C_e(T)}{T}dT + \frac{C'_H(H,T)}{T}dT + \left(\frac{\partial S_{M(H,T)}}{\partial H}\right)_T dH$$
(3.89)

şeklinde yazılabilir. (3.89) eşitliğindeki son iki terim manyetik entropi S_M 'nin toplam diferansiyelini verir:

$$dS_{M}(H,T) = \frac{C'_{H}(H,T)}{T}dT + \left(\frac{\partial S_{M}(H,T)}{\partial H}\right)_{T}dH$$
(3.90)

(3.24)'deki Maxwell eşitliği kullanılarak da

$$dS_{M}(H,T) = \frac{C'_{H}(H,T)}{T}dT + \left(\frac{\partial M(H,T)}{\partial T}\right)_{T}dH$$
(3.91)

şeklinde elde edilir.

Görüldüğü gibi, dS_M iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birisi sıcaklık değişimi (alan sabit iken) diğeri ise manyetik alan değişimini (izotermal kısım) ifade etmektedir. Bu iki kısmı ayırt etmek için parçalardan birincisini dS_{MH} ikincisini dS_{MT} olarak gösterelim.

Sıcaklık değişiminin $\Delta T = T_2 - T_1$ ve H değişiminin $\Delta H = H_2 - H_1$ olduğu durumda toplam manyetik entropi değişimi şu şekilde hesaplanabilir:

$$\Delta S_{Mtot}(H,T) = S_M(H + \Delta H, T + \Delta T) - S_M(H,T)$$

= $\int_{H}^{H+\Delta H} \left(\frac{\partial M(H,T + \Delta T)}{\partial T}\right)_{H} dH + \int_{T}^{T+\Delta T} \frac{C'_H(H,T)}{T} dT$ (3.92)

İzotermal manyetik entropi değişimi, manyetik alan değişiminin $\Delta H = H_2 - H_1$ olması durumunda (3.24) Maxwell eşitliğinden faydalanarak, mıknatıslanma verileri temel alınarak hesaplanabilir ve

$$\Delta S_{MT}(H,T) = S_M(H_1,T) - S_M(H_2,T) = \int_{H_1}^{H_2} \left(\frac{\partial S_M(H,T)}{\partial H}\right)_T dH$$

$$= \int_{H_1}^{H_2} \left(\frac{\partial M(H,T)}{\partial T}\right)_H dH = S(H_2,T) - S(H_1,T) = \Delta S(H,T)$$
(3.93)

şeklinde tanımlanabilir. ΔS_{MT} 'nin, toplam entropinin izotermal değişimi ΔS 'ye eşit olduğuna dikkat etmelidir. Bu durum S_I ve S_e değerleri H'ye bağlı olmadığında geçerlidir.

(3.92) eşitliğindeki ikinci integral ΔS_{MH} 'a manyetik entropinin izoalan değişimini tanımlar. ΔS_{MT} ve ΔS_{MH} tarafından yapılan etki şekil 3.3'de gösterilmiştir. Burada izobarik-adyabatik mıknatıslanma sürecinde ferromanyetik malzeme için manyetik alan $H_1 = 0$ ve $H_2 > 0$ iken S_M manyetik entropinin sıcaklığa bağlılığı gösterilmiştir. Bilindiği üzere ferromanyetik veya paramanyetiklerin manyetik entropisi manyetik alan içerisinde azalır, bu durum $H \neq 0$ ve H = 0 iken şekil 3.3'de gösterilmiştir. Bu süreçte toplam entropi değişimi sıfıra eşittir (S(T,H) = sabit) ve malzemenin başlangıç sıcaklığı T, manyetokalorik etkiye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sürecin sonu entropi değişiminin sıralı toplamı olarak düşünülebilir: İzotermal (T=sabit) iken manyetik alanın değişimi $H_1 \rightarrow H_1 + \Delta H = H_2$ (izotermal entropi değişimi ΔS_{MT} ile ilgili olarak şekil 3.3'de süreç 1 \rightarrow 2) ve sabit manyetik alan (H=sabit) altında sıcaklık değişimi ($T \rightarrow T + \Delta T$) (izoalan içerisinde entropi değişimi ΔS_{MH} ile ilgili olarak şekil 3.3'de süreç 2 \rightarrow 3) şeklindedir. Burada ΔT , sonlu alan değişimi $\Delta H = H_2 - H_1$ tarafından sebep olunan manyetokalorik etkinin sonlu değeridir. Hem izotermal hem de izoalan kısımlar adyabatik mıknatıslanma veya demıknatıslanma altında manyetik entropinin toplam değişimine katkı sağlar. İzoalan etkisinin ($\Delta S_{MH}(T,H)$) artışı toplam $\Delta S_{Mtot}(T,H)$ değerinin azalmasına ve manyetokalorik etkinin artmasına neden olur (2 ve 3 noktaları arasındaki mesafe).



Şekil 3.3. Bir ferromanyetik malzemede iki farklı H_1 ve H_2 ($H_2 > H_1$) alanında manyetik entropinin sıcaklığa bağlı olarak değişimi.

Bu durumda manyetik entropinin toplam adyabatik değişimi $\Delta S_{Mtot}(T,H)$ ve manyetik entropinin izotermal değişimi $\Delta S_{MT}(T,H)$, belirgin şekilde farklılık gösterebilir ve eşit kabul edilemez. ΔS_{Mtot} ve ΔS_{MT} değerleri yalnızca küçük C'_H / T değerlerinde (örneğin manyetik etkinin küçük değerlerinde birbirlerine yaklaşırlar, C'_H 'ın ısı kapasitesinin toplamına ve/veya yüksek sıcaklıklarda) ve/veya ΔT 'nin küçük değerlerinde (2 ve 3 noktaları birbirinde yakın olduğunda: Şekil 3.3'de görüldüğü gibi) manyetokalorik etkinin değeri (T ekseninde 2 ve 3 noktaları arasındaki mesafe) ΔS_{MH} 'nin değerleri ve ΔS_{MT} 'nin ΔT eğrisi üzerindeki etkisi ile $S_M(T)$ 'nin yer değişimi doğrultusunda belirlenir. Oda sıcaklığında katılarda spin-örgü gevşeme zamanı yaklaşık olarak 10^{-12} saniye [28] ve Ahiezer ve Pomeranchuk'e göre bu değer 10^{-4} *K*'de yaklaşık 1 saniye kadardır. Bu durum (3.89) eşitliğinden faydalanarak

$$\frac{C_1(T)}{T}dT + \frac{C_e(T)}{T}dT = -\left[\left(\frac{\partial S_M(T,H)}{\partial H}\right)_T dH + \frac{C_H(T,H)}{T}dT\right]$$
(3.94)

şeklinde tanımlanabilir.

Genellikle, manyetokalorik etki deneylerinde net örgü sıcaklığı ölçülebilir. Ancak, dengede olmayan bazı özel durumlarda (örneğin manyetik, elektrik ve örgü altsistemleri arasında enerji değişiminin mümkün olmadığı) elektronların ve örgü altsistemlerinin sıcaklıkları farklılık gösterebilir.

(3.94) eşitliğinden hareketle adyabatik-izobarik süreç altında manyetokalorik etki büyüklüğü

$$dT(T,H) = -\frac{T}{C_{H}(T,H)} \left(\frac{\partial M(T,H)}{\partial T}\right)_{H} dH$$

$$= -\frac{T}{C_{H}(T,H)} dS_{MT}(T,H) = -\frac{T}{C_{H}(T,H)} \left(\frac{\partial M(T,H)}{\partial T}\right)_{H} dH$$
(3.95)

şeklinde elde edilebilir.

(3.95) eşitliğinden dT değerinin, Maxwell bağıntısı (3.24) ile hesaplanabilen S_M 'nin izotermal değişimi ile orantılı olduğu sonucuna ulaşılabilir ve sıcaklık değişiminden ileri gelen manyetik entropi değişimi toplam ısı kapasitesine bağlı olarak manyetokalorik etkiyi dolaylı yoldan etkiler. Ancak manyetokalorik etkinin sınır değeri izobarik adyabatik süreçte izoalan adyabatik ΔS_{MH} değişimiyle belirlenir. Manyetokalorik etki maksimum değerine ΔS_{Mtot} sıfıra eşit olduğunda ulaşır. Bu durumda $\Delta S_{MH} = \Delta S_{MT}$ şartı vardır. Manyetik adyabatik gibi bir durum altında manyetokalorik etki değeri (3.90) ve (3.91) eşitliklerinden hareketle

$$dT(T,H) = -\frac{T}{C'_{H}(T,H)} \left(\frac{\partial S_{M}(T,H)}{\partial H}\right)_{T} dH = -\frac{T}{C'_{H}(T,H)} \left(\frac{\partial M(T,H)}{\partial T}\right)_{H} dH \qquad (3.96)$$

şeklindeki formül ile hesaplanabilir. (3.96) eşitliğinde manyetik ısı kapasitesi C'_H 'nın (3.95)'deki örgü ve elektron katkısını içeren toplam ısı kapasitesi C_H yerine kullanıldığına dikkat edilmelidir. Benzer sonuçlar $S(H_2, T)$ ve $S(H_1, T)$ durumlarında $H_2 > H_1$ iken antiferromanyetiklerin değişim durumunda geçerlidir.

Literatürde manyetokalorik etkiye bağlı olarak, izotermal manyetik entropi değişimi ΔS_{MT} genellikle farklı hesaplamalar kullanılır. Bu nedenle, buradan itibaren manyetik entropi değişiminde *T* indisi belirlenir ve yok sayılacaktır. Sadece ΔS_M veya dS_M kullanılabilir. Bu durumun, özel durum olmadığı sürece izotermal manyetik entropi değişiminde olduğu unutulmamalıdır.

Manyetik entropinin değişimi dS_M son derece az olduğunda

$$\Delta S_M(T) = \frac{C_H}{T} dT \tag{3.97}$$

şeklinde yazılabilir. (3.97) eşitliğinin integrali alınırsa, termodinamiğin üçüncü yasasından hareketle T = 0 iken entropinin sıfır olacağı bilindiğinden, entropi değişimi $\Delta S(T)$ ve manyetik entropi değişimi $\Delta S_M(T)$, ısı kapasitesi $C_H(T)$ ye bağlı olarak

$$\Delta S_M(T) = \Delta S(T) = \int_0^T \frac{\left[C_H(H_2, T) - C_H(H_1, T)\right]}{T} dT$$
(3.98)

şeklinde yazılır. (3.98) eşitliği göz önüne alınacak olursa, $\Delta S(T)$ ve $\Delta S_M(T)$ 'nin büyük değerleri, düşük sıcaklık aralığında ve H_1 ve H_2 'de ısı kapasiteleri arasındaki büyük fark için beklenebilir. (3.98) eşitliği için bir fonksiyonun ekstremum ve maksimum veya minimum şartı uygulanarak $\Delta S_M(T)$ (veya $\Delta S(T)$) noktasını belirlemek mümkündür. Pecharsky'nin sonuçlarına göre $\Delta S_M(T)$ 'deki maksimum değer [29]:

$$C_H(H_1,T) = C_H(H_2,T) \text{ ve } \frac{\partial C_H(H_2,T)}{\partial T} < \frac{\partial C_H(H_1,T)}{\partial T}$$
(3.99)

ve minimum değer

$$C_H(H_1,T) = C_H(H_2,T) \text{ ve } \frac{\partial C_H(H_2,T)}{\partial T} > \frac{\partial C_H(H_1,T)}{\partial T}$$
(3.100)

için gözlenir. (3.99) ve (3.100) denklemlerinde verilen şartlar, Şekil 3.4 (a) ve (b)'de gösterilmiştir. Şekilde H = 0, 53.2 ve 98.5 kOe değerlerinde ErAgGa'nın ısı kapasitesi verileri kullanılarak manyetik entropi değişimi (3.98) eşitliğinden faydalanarak hesaplanmıştır. Şekil 3.4'den de görüleceği üzere ErAgGa için (3.100) şartı $\Delta SM(T)$ 'nin minimumuna bağlıdır. Minimum sıcaklık değerleri H=0'da C(T) eğrisi ve $H \neq 0$ 'da uygun C(T) eğrisi arasında kesişirleri belirlenir (Şekil 3.4'de kesişirler koyu noktalarla belirtilmiştir). $\Delta S_M(T,H)$ 'a ait minimum ve maksimum değerleri manyetik faz dönüşümleri noktası yakınlarında gözlenir [29].



Şekil 3.4. (a) Isı kapasitesinin (b) Manyetik entropi değişiminin sıcaklığa bağlılığı.

 H_1 'den H_2 'ye manyetik alanın adyabatik değişimi sadece manyetik entropi ΔS_M 'de değişikliğe neden olmaz. Bunun yanında T_1 'den T_2 'ye sıcaklık değişimine de neden olur (manyetokalorik etki $\Delta T = T_2 - T_1$). Bu süreç Şekil 3.5'te gösterilmiştir. Burada toplam entropi sıcaklığı tipik bir ferromanyetik için H = 0 ve $H \neq 0$ değerleri için gösterilmiştir. Bu diyagrama göre verilen ΔT sıcaklığında MCE $S(T,H_1) = S(T + \Delta T,H_2)$ adyabatik şartı ile belirlenebilir. (3.95) eşitliğinin integrali manyetokalorik etki ΔT 'yi açıklar:



Şekil 3.5. Sıfır ve sıfırdan farklı manyetik alanda basit bir ferromanyetiğin toplam entropisi S(T)'nin sıcaklığa bağlılığı.

$$\Delta T(T, \Delta H) = T \left\{ \exp\left[-\int_{H_1}^{H_2} \frac{dS_M}{C_H(T, H)} \right] - 1 \right\}$$

$$= T \left\{ \exp\left[-\int_{H_1}^{H_2} \frac{\partial M(T, H) / \partial T}{C_H(T, H)} dH \right] - 1 \right\}$$
(3.101)

Isı kapasitesinin manyetik alana bağlı olmadığı düşünülürse (3.101) eşitliği daha sade olarak

$$\Delta T(T, \Delta H) = T \left\{ \exp\left[-\frac{\Delta S_M(T, \Delta H)}{C_H(T)} \right] - 1 \right\}$$
(3.102)

şeklinde yazılabilir. (3.102) eşitliği $\Delta T(T; \Delta H)$ 'nin davranışı ve ΔS_M ile ilgisi hakkında bazı sonuçlara izin verir. ΔT değeri ΔS_M negatif iken pozitiftir ve işareti $\Delta S_M = 0$ iken değişir. Kıvrık parantez içindeki açılımın $\Delta S_M < 0$ için ΔS_M mutlak değerinin artmasıyla eksponansiyel olarak arttığına dikkat etmelidir. Eğer $\Delta S_M(T)$ mutlak değer olarak yüksek bir değere sahipse ΔT 'nin bir maksimumu olmalıdır. Pozitif ΔS_M için (antiferromanyetiklerde görülür) kıvrık parantez içindeki açılım, küçük $\Delta S_M / C_H$ için küçük negatif değerle sahiptir ve büyük $\Delta S_M / C_H$ için artarak -1 değerine ulaşmasıyla hızlı şekilde azalır. Bu durumda $\Delta T \approx -T$ şartı vardır ve büyük $\Delta S_M / C_H$ değerleri için ΔS_M 'ye bağlı değildir.

(3.101) eşitliği daha fazla basitleştirmek istenirse, üstel fonksiyon açılımında $\Delta S_M/C_H$ küçük farzedilebilir. Tsihin (1997)'nin de dikkat çektiği [30] gibi, bu varsayımlar yalnızca bağıl olarak zayıf alanlarda geçiş noktalarından uzak bölgede vardır. Elde edilen eşitlik şu şekilde olur:

$$\Delta T = -\frac{T\Delta S_M}{C_H} \tag{3.103}$$

(3.87) eşitliğinden ΔT değerinin sıcaklık artışıyla arttığı görülmektedir (aynı ΔS_M ve C_H için) ve daha büyük ΔT 'nin, düşük toplam ısı kapasitesine sahip olan malzemelerde olması beklenir. Burada Debye sıcaklığı T_D 'nin üzerinde katının ısı kapasitesine örgü katkısının *3R* değerine yaklaştığına (DuLong-Petit limiti) ve bu faktörün T_D 'nin üzerindeki yüksek sıcaklık bölgesinde ΔT 'nin artmasında rol oynadığına dikkat etmelidir. Debye sıcaklığı manyetokalorik etki üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Yukarıdaki bilgilere göre, ferromanyetik ve paramanyetiklerde en yüksek manyetokalorik etki değerine, negatif S_M 'nin yüksek mutlak değerinde, elektron iletkenliğinin ve örgü altsisteminin ısı kapasitesine etkisi az olduğunda ulaşılmaktadır. Örgü şartları düşük sıcaklık bölgesinde C_e ve C_l sıfıra yaklaşırken sağlanabilir. Ayrıca manyetokalorik etkinin değerinin sıcaklık ile doğrudan orantılı olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Pecharsky [29] bu konuda yaptığı deneylerle (3.103) eşitliğini doğrulamak için ekstremum noktasında ΔT 'nin davranışını incelemiştir ve genel anlamda minimum (veya maksimum) $\Delta T(T)$ değerinin $\Delta S_M(T)$ 'deki sıcaklıkla ilgili olmadığını göstermiştir. Maksimum $\Delta T(T)$ şartları

$$C(T, H_2) \ge C(T, H_1)$$
 ve $\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{T}{C(T, H_2)} \right) \ge 0$ (3.104)

veya

$$C(T, H_2) \le C(T, H_1)$$
 ve $\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{T}{C(T, H_2)} \right) \le 0$ (3.105)

şeklindedir. Söz konusu şartlar ErAgGa için Şekil 3.6 (a) ve (b)'de T/C(H, T)'nin ve $\Delta T(T)$ 'nin sıcaklığa bağlı değişimlerinde görülmektedir [29]. Şekilde manyetik alan

H=53,2 ve 98,5 kOe değerlerindedir. Burada düşük sıcaklıklarda d/dT(T/C(H, T)) < 0şartı vardır ve $\Delta T(T)$ 'nin maksimum değeri $C(T,H_2) \leq C(T,H_1)$ için gözlenebilir. (Şekil 3.6(a)) sıcaklık 10*K*'in altındaki değerdedir. ErAgGa'da $\Delta T(T)$ 'nin maksimumu (Şekil 3.6(b)), $\Delta S_M(T)$ 'nin maksimum noktalarındaki sıcaklığında daha düşük bir sıcaklık olan 7*K* civarında gözlenir.

Paramanyetik ve ferromanyetik için T_C üzerindeki ΔS_M değeri (3.63), (3.70) ve (3.93) eşitlikleri kullanılarak:

$$\Delta S_{M} = -\frac{1}{2} \frac{C_{J} \Delta (H)^{2}}{T^{2}}$$
(3.106)

$$\Delta S_{M} = -\frac{1}{2} \frac{C_{J} \Delta (H)^{2}}{(T - T_{C})^{2}}$$
(3.107)

şeklinde hesaplanabilir. Burada $\Delta(H)^2 = H_2^2 - H_1^2$ dir.



Şekil 3.6. (a) T/C nin (b) ΔT nin sıcaklığa bağlılığı.

(3.91) ve (3.92) eşitliklerinde ΔS_M 'nin büyük değerinin, M_{eff} değerli manyetik malzemelerde ve paramanyetikler için ve θ *K*'e yakın ferromanyetikler için T_C 'ye yakın sıcaklık oranlarında beklendiği açıktır. T_C sıcaklığı civarında ferromanyetiklerde ΔS_M 'nin alana bağlılığı Oesterreicher ve Parker tarafından şu şekilde açıklanmıştır [31]:

$$\Delta S_M = -1.07 N k_B \left(\frac{g_J \mu_B J H}{k_B T_C}\right)^{2/3}$$
(3.108)

Bu eşitlikten T_C civarında $\Delta T \approx H^{2/3}$ olduğu görülmektedir ((3.103)'de görüldüğü gibi).

Bazı deneylerde, manyetik entropi S_M 'nin hesaplarında manyetokristalik anizotropi etkisinin hesaba katıldığı çalışmalar olmuştur. Bennett [32], aşağıda verilen toplam Hamiltoniyen ifadesini kullanarak eksensel anizotropili bir ferromanyetiğin manyetik entropisini düşünmüştür:

$$\hat{H} = -\sum_{i>j} M_{ij} \hat{s}_{i} \hat{s}_{j} - \mu_{B} \sum_{i} (\hat{s}_{i} \vec{H} + a \hat{s}_{zi})$$
(3.109)

Burada s_i spin açısal momentum operatörüdür ve manyetik alan z ekseni boyunca yönlenmiştir. Eğer a > 0 ise spinlerin tercihli yönleri $\pm z$ yönündedir (tek eksenli anizotropi), a < 0 için spinler z eksenine dik düzlemde bulunur (düzlemde anizotropi). 20 x 20 x 20 fcc örgüsünün toplam manyetik momenti (3.109)'da verilen Hamiltoniyen kullanılarak Monte Karlo yöntemiyle hesaplanmıştır ve ΔS_M , $H_1 = 0$ ve $H_2 = 10$ kOe için (3.93) eşitliği kullanılarak belirlenmiştir. Tek eksenli anizotropi durumu için, *a*'nın arttığı ve T_C civarında ΔS_M artışının olduğu durumda kuvvetlenmelerin olduğu, ancak geri kalan sıcaklık aralığında eğrilerin hemen hemen benzer olduğu görülmüştür. Ancak düzlemsel anizotropide, T_C civarında ΔS_M 'de artış ve paramanyetik bölgede *a*'nın artışıyla T_C sıcaklığının üstünde azalma söz konusudur.

Druzhinin [33], (3.65) eşitliğindeki Hamiltonyenini kullanarak tek iyon hegzagonal manyetokristalik anizotropi formülünü şu şekilde hesaplamıştır:

$$\hat{H}_{a} = -\sum_{i} \left(a \hat{J}_{z}^{2} + b \hat{J}_{z}^{4} + c \hat{J}_{z}^{6} + \frac{d}{2} (\hat{J}_{+}^{6} + \hat{J}_{-}^{6}) \right)$$
(3.110)

Şekil 3.7, ferromanyetik EuS için tipik toplam entropi S(T,H), manyetik entropi $S_M(T,H)$ ve manyetik entropi değişimi $\Delta S_M(T,H)$ 'nin durumunu göstermektedir. Yüksek sıcaklıklarda $S_{\rm M}(T,H)$ üst limiti olan Rln(2J + 1) ((3.87)'te görüldüğü gibi) değerine yaklaşır ve $\Delta S_{\rm M}(T,H)$, T_C civarında maksimuma sahiptir. Yüksek sıcaklık bölgesinde gözlenen toplam entropi artışı, örgü ve iletkentik elektronlarının entropisinin artmasıyla olmaktadır [34].



Şekil 3.7. EuS için farklı H manyetik alanlarında, manyetik entropi değişimi $\Delta S_M(T,H)$ 'nin, manyetik entropi $S_M(T,H)$ 'nin ve toplam entropi S(T,H)'nin sıcaklığa göre değişimi.

(3.110) eşitliğindeki *a, b, c* ve *d* katsayıları kristal alan katsayısı A^{m_1} ile ilgilidir [35] ve manyetik entropi S_M , Boltzmann eşitliği ile

$$S_{M} = -k_{B}N\sum_{n} \frac{\exp(-E_{n}/k_{B}T)}{Z} \ln\left[\frac{\exp(-E_{n}/k_{B}T)}{Z}\right]$$
(3.111)

şeklinde hesaplanmıştır. S_M hesaplamaları H = 0 iken Tb ve Dy için yapılmıştır [36]. Sonuçları MFA nın teorik çerçevesinde (3.65) izotropik Hamiltoniyenin temeli üzerinde yapılan hesaplamalardan deneysel veriler ile daha iyi uyum gösterir.

 μ manyetik momentli *N* parçacıktan oluşan sistemin, bölüşüm fonksiyonu, serbest enerjisi ve manyetik entropisi klasik limitte

$$Z_{\infty} = 4\pi \frac{\sinh x}{x} \tag{3.112}$$

$$F = -k_B T \ln(Z_{\infty}(x))^N \tag{3.113}$$

$$S_{M} = Nk_{B} \left[\ln\left(4\pi \frac{\sinh x}{x}\right) - x\ln(x) \right] = Nk_{B} \left[1 - x \coth x + \ln\left(4\pi \frac{\sinh x}{x}\right) \right] \quad (3.114)$$

şeklindedir. Burada x değerleri (3.75) ve (3.76) eşitlikleri ile belirlenir.

Kuantum durumundaki gibi, klasik limitte H_1 'den H_2 'ye manyetik alanlarında manyetizasyon altında manyetik entropi değişimi (3.93) eşitliği

$$\Delta S_M = \int_{H_1}^{H_2} \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H dH = -\frac{N\mu^2}{6k_B} \frac{\Delta(H)^2}{T^2}$$
(3.115)

şeklinde hesaplanır ve $T > T_C$ iken ferromanyetikler için

$$\Delta S_{M} = -\frac{N\mu^{2}}{6k_{B}} \frac{\Delta(H)^{2}}{(T - T_{C})^{2}}$$
(3.116)

klasik limitte elde edilir.

Daha genel bir yaklaşımla, manyetik alanın sıfırdan H'ye kadar değişimi sonucunda oluşan ΔS_M değişimi

$$\Delta S_{M} = S_{M}(T, H) - S_{M}(T, 0) = Nk_{B} \left[1 - x \coth x + \ln \frac{\sinh x}{x} \right]$$
(3.117)

şeklindedir.

Manyetik alanın yokluğunda T_C sıcaklığının altında bir ferromanyetikte kendiliğinden oluşan manyetizasyonun sebep olduğu manyetik entropi değişimi Landau'nun ikinci dereceden faz geçişleri teorisi ile tanımlanabilir. Termodinamik potansiyel Φ için (3.45) eşitliği dengedeki kendiliğinden manyetizasyon için (3.47) eşitliği ve $S = -d\Phi/dT$ eşitliği kullanılarak entropi değişimi için

$$\Delta S_M = -\frac{\alpha_{\Theta}}{2}M_s^2 = -\frac{(\alpha_{\Theta})^2}{2\beta}(T - T_C)$$
(3.118)

ifadesi elde edilebilir.

3.8. Mıknatıslanma Ölçümleri ile Manyetokalorik Etkinin Belirlenmesi

Mıknatıslanma izotermleri M(H) üzerindeki deneysel veriler (3.93) eşitliği ile manyetik entropi değişimi ΔS_M 'yi hesaplamada kullanılabilir:

$$\Delta S_M = \int_{H_1}^{H_2} \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H dH$$
(3.119)

veya alan sıfırdan H'ye değişirse manyetik entropi değişimi

$$\Delta S_M = \int_0^{H_2} \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H dH \tag{3.120}$$

şeklindedir.

(3.119) ve (3.120) eşitlikleri istenilen sıcaklık ve manyetik alan aralığında T_1 , T_2 ,.... gibi farklı sıcaklıklardaki mıknatıslanma izotermleri M(H) durumu göz önüne alınarak sayısal olarak integrallenebilir. dM/dT türevi de sayısal olarak hesaplanabilir. McMichael [37] ΔS_M 'nin sayısal hesaplamaları için aşağıdaki basit formülü ileri sürmüştür:

$$\left|\Delta S_{M}\right| = \sum_{i} \frac{1}{T_{i+1} + T_{i}} (M_{i} - M_{i+1}) \Delta H_{i}$$
(3.121)

Nadir toprak metallerinde ΔS_M 'nin mıknatıslanma izotermlerindeki sayısal hesaplamaları McMichael [37], Foldeaki [38], Dan'kov [39], Pecharsky ve Gschneidner [40] ve diğer kişiler tarafından yapılmıştır.

(3.119) ve (3.120) eşitlikleri ikinci derece manyetik faz geçişi sistemlerinin verilerinden manyetik entropi mıknatıslanma değişiminin hesaplanmasında kullanılabilir. Çünkü birinci derece geçişlerinde dM/dT türevinin değeri sonsuzdur. Birinci derece manyetik faz geçişi ile ilişkili olan manyetik entropi değişimi Clapeyron-Clausisus eşitliği kullanılarak belirlenir. Ancak sonsuz dM/dT değeri yalnızca birinci derece faz geçişlerinde ortaya çıkar ve gerçek malzemelerde (3.119) ve (3.120) eşitliklerinin kullanıldığı durumda dM/dT genelde sonlu olur. Ancak (3.119) ve (3.120) eşitlikleri birinci derece faz dönüşümü için kullanılacak olursa bazı durumlarda ΔS_M 'nin aşırı değere sahip olabileceğine dikkat edilmelidir. (3.119) ve (3.120) eşitliklerinin kullanımıyla ilgili tartışmalar Giguere [41], Sun [42], Gschneidner [43] ve Wada [44] tarafından yapılmıştır.

Mıknatıslanma ve ısı kapasitesinin deneysel verilerinden manyetokalorik etkinin ΔT değerinin hesaplanmasında (3.35) eşitliği kullanılabilir:

$$\Delta T(T,H) = \int_{T(H=0)}^{T(H)} dT = -\int_{0}^{H} \frac{T}{C_{H,p}} \left(\frac{\partial M(H,T)}{\partial T}\right)_{H} dH$$
(3.122)

burada $\Delta T(T, H) = T(H) - T(H = 0)$ eşitliği mevcuttur. *T*'nin manyetik alan hareketi ile tamamen değiştiğine ve $C_{p,H}$ değerinin *H*'ye kuvvetli bir şekilde bağlı olduğuna dikkat etmelidir. Bu nedenle *T* ve $C_{p,H}$ ifadelerinden hiçbiri (3.122) eşitliğinde integral dışına alınamaz. Deney esnasında alan genellikle H = 0 değerinden *H* değerine doğru değişir. Bu durumda manyetik alan değeri H_1 'den H_2 'ye değişir. Bu değerler (3.121) eşitliğinde integralin sınırları olarak alınabilir. İntegralin parçalara ayrılması ile (3.121) eşitliğini şu şekilde yazmak mümkündür [38]:

$$\int_{0}^{H_{0}} \frac{T}{C_{H,p}} \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{H} dH = \left[\frac{T}{C_{H,p}} \int_{0}^{H} \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{H'} dH'\right]_{0}^{H_{0}} - \int_{0}^{H_{0}} \left\{\frac{d}{dH} \left(\frac{T}{C_{H,p}}\right) \left[\int_{0}^{H} \left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)_{H'}\right]\right\} dH \quad (3.123)$$

Eğer T/C_{pH} değeri manyetik faz geçişlerinin bölgesinde olduğu varsayılan $(dM/dT)_H$ türevinden çok daha yavaş olarak H ile değişiyorsa, o zaman (3.123) eşitliğindeki ikinci integral ihmal edilir ve manyetokalorik etki

$$\Delta T(T,H) = -\frac{T}{C_{p,H}(T,H)} \Delta S_M(T,H)$$
(3.124)

şeklinde hesaplanabilir (Ayrıca (3.103) eşitliğinde görüldüğü gibi). Foldeaki'ye göre (3.124) eşitliğindeki ΔS_M ve $C_{p,H}$ değerleri aynı sıcaklık ve alanda tanımlanmalıdır [45]. Verilen *H* manyetik alanında ısı sığası deneysel olarak ölçülen sıfır alan ısı sığasından hareketle belirlenebilir ve (3.29) eşitliği ΔS_M verilerinden manyetik alanın sebep olduğu ısı kapasitesi değişimi hesabına izin verir:

$$\Delta C_p = C_p(H) - C_p(0) = T \left(\frac{\partial \Delta S_M}{\partial T}\right)_p$$
(3.125)

Burada $\Delta S_{\rm M} = S_{\rm M} (H) - S_{\rm M} (0)$ eşitliği söz konusudur. (3.124) eşitliği yalnızca ısı sığası manyetik alana bağlı olmadığında geçerliğidir. Örneğin $C_p(0, T) = C_p(H, T)$. Foldeaki hesaplamalarına göre hesaplanan ΔSM değerindeki hata 60 kOe (±7.5%) mıknatıslanma ortamında %0.5'ten daha azdır [38]. Pecharsky ve Gschneidner ΔS_M değerindeki hataları yukarıda bahsedilen yöntemle hesaplayarak analiz etmişlerdir [40]. ΔS_M yamuk kuralı kullanılarak

$$\Delta S_M(T_{ort}) = \frac{\delta H}{2\delta T} \left(\delta M_1 + 2\sum_{k=2}^{n-1} \delta M_k + \delta M_n \right)$$
(3.126)

şeklinde hesaplanmıştır.

Her izotermdeki mıknatıslanmanın *n* alan noktalarında $\delta H = \Delta H/(n - 1)$ aralıkları ile bulunduğu varsayılmıştır. Burada ΔH manyetik alan değişimini ifade etmektedir. (3.126) eşitliğinde, $ST = T_u - T_l$ değeri T_u ve T_l sıcaklıklarında ölçülen iki izoterm arasındaki sıcaklık farklıdır, $T_{ort} = (T_u + T_l)/2 \Delta S_M$ 'nin hesaplandığı ortalama sıcaklık, 1'den *n*'ye her manyetik alan noktasında T_u ve T_l 'de ölçülen izoterimlere bağlı manyetizasyonlardaki farktır.

Manyetizasyon, manyetik alan ve sıcaklık ölçümleri ile ilgili sapmalarda ortaya çıkan hatalar hesaba katılmıştır. Aşağıdaki eşitlik ΔS_M değerindeki toplam hata için oluşturulmuştur:

$$\sigma \left| \Delta S_{M} \left(T_{av}, \Delta H \right) \right| = \frac{1}{2|\delta T|} \begin{cases} \left| \delta H \left| \left(\sigma M_{1} + 2 \sum_{k=2}^{n-1} \sigma M_{k} + \sigma M_{n} \right) \right. \right. \right. \\ \left. + \left(\left| \delta M_{1} \right| \sigma H_{1} + 2 \sum_{k=2}^{n-1} \left(\left| \sigma M_{k} \right| \sigma M_{k} \right) + \left| \sigma M_{n} \right| \right) \right. \\ \left. + 2 \left| \Delta S_{M} \left(T_{av}, \Delta H \right) \right| \left(\sigma T_{u} + \sigma T_{1} \right) \end{cases} \right\}$$
(3.127)

burada, σT sıcaklık ölçümlerinden kaynaklanan hatalardır, $\sigma M_k = [\sigma M(T_u)_k + \sigma M(T_1)_k]$ ifadesi H_k manyetik alanında T_u ve T_l sıcaklıklarında mıknatıslanma ölçümlerinden kaynaklanan hatalar toplamıdır ve $\sigma H_k = [\sigma H(T_u)_k + \sigma H(T_l)_k]$ ifadesi T_u ve T_l sıcaklıklarındaki manyetik alan hatalarının toplamıdır. (3.127) eşitliğindeki birinci terim etki mıknatıslanma sapmaları, ikinci terim alan sapmaları ve üçüncü terim sıcaklık sapmaları ile ilgili katkıları göstermektedir. (3.127) eşitliğinin analizi manyetik entropideki toplam hatanın δT ve δH azalırkan arttığını göstermektedir. Bu değerlerin çok büyük değerler olmadığı unutulmamalıdır. Aksi takdirde (3.126) eşitliği geçersiz bir eşitlik olacaktır.

Şekil 3.8'de polikristal ErAl₂ ve tek kristal Gd (alan [0001] boyunca yönlenmiştir) için deneysel manyetizasyon verileri üzerine (3.126)'eşitliği ile hesaplanan $\Delta S_M(T)$ bağımlılığı (daireler ve üçgenler) ve aynı zamanda (3.127) eşitliği ile hesaplanan $\sigma | \Delta S_M(T) |$ uygun toplam hatanın (noktalı çizgiler) sıcaklık bağımlılığı görülmektedir. Ölçümler Curie noktaları bölgesinde ErAl₂ için T_C yakınlarında 1 K ve Gd için bütün sıcaklık aralığında 5 K, T_C üzerinde ve 2K'in altında ise δT sıcaklık aralıkları ile yapılmıştır. ErAl₂ için manyetik alan 6H noktasında 1 kOe ve Gd için 2 kOe dir. Manyetizasyon ölçümlerinin doğruluğu %0.5 ve manyetik alan için %0.1 olduğu farzedilmiştir. Sıcaklıktaki doğruluk ise $\Sigma T = 0.1K + 0.001T$ şeklinde hesaplanmıştır [40].



Şekil 3.8. Gd ve ErAl_2 için $\Delta H = 50kOe$ iken manyetik entropi değişimi ve $\Delta S_M(T)$ 'nin sıcaklığa bağlılığı.

Şekil 3.9'da ΔS_M 'de bağıl toplam hatanın sıcaklığa bağlılığı ve ErAl₂ ve Gd için (3.127) eşitliğine göre farklı sapmaların katkısı görülmektedir. Görüldüğü gibi, ErAl₂ ile karıştırılan Gd'de δH 'nin iki kat artması uygun manyetik alanın toplam hataya katkısını da iki kat azaltmamaya sebep olmaktadır. ErAl₂'deki δT 'nin iki katlık azalması (sıcaklık aralığının 15'ten 20 *K*'e getirilmesi) mıknatıslanma ve sıcaklık hatalarında artışa sebep olmaktadır. Ayrıca bağıl hata ΔH değerine bağlıdır. Bağıl hata δH 'nin sabitliğini sağlayan daha düşük ΔH için düşüktür. ΔS_M 'deki toplam bağıl hata aslında manyetizasyon katkılarında artmaya sebep olan Curie sıcaklığının altında artmıştır. Manyetik alan ve sıcaklıktan kaynaklanan hatalar küçüktür ve sıcaklığa bağlıdır. Curie sıcaklığı yakınlarında toplam bağıl hata ErAl₂ ve Gd'de yaklaşık %25'tir ve düşük sıcaklık bölgesinde hızlı bir şekilde kötüleşmektedir.



Şekil 3.9. ErAl₂ ve Gd için ΔS_M 'de bağıl toplam hatanın sıcaklığa bağlılığı.

4. BÖLÜM

DENEYSEL YÖNTEMLER

4.1. Örneklerin Elde Edilmesi

Çalışmamızda kullanılan örnekler, bileşiği oluşturan Ce, Gd, Co ve B elementlerinin ark fırını kullanılarak su soğutmalı bakır pota içinde eritilmesi yöntemiyle elde edilmiştir. Oksitlenmeyi engellemek için eritme işlemi argon atmosferi içinde yapılmıştır. Bakır potada oluşan ısı, içinden geçirilen su ile alınarak hem erimesi hem de üretilen örneğe bakır bulaşması engellenir. Kullanılan Ce'un saflığı %99,9, Gd'un saflığı %99,9, Co'ın saflığı %99,5 ve B'un saflığı ise %99,7'dir. Eritme işleminden önce parça şeklindeki saf elementler 0.1 mg hassasiyete sahip elektronik terazi ile mol oranlarına göre tartılmıştır. Örneklerin homojen olması için eritme işlemi birkaç defa yapılmıştır.



Şekil 4.1. Örneklerin üretilmesinde kullanılan ark fırını.

Örnek, şekil 4.1'de gösterilen en yüksek 200 A akım verebilen güç kaynağına sahip ark fırını (Edmund Bühler Mini Arc Metler MAM-1) ile üretilmiştir.

4.2. X-ışını Toz Kırınımı

4.2.1. X-ışını Kırınımı

Kristal yapı analizinde kullanılan yöntemlerden biri de x-ışını kırınım yöntemidir. Bir kristalde kırınım olayı, W. L. Bragg tarafından 1912 yılında açıklanmıştır [46]. Aralarındaki uzaklık *d* olan ve aynı Miller indislerine sahip düzlemlerden yansıyan x-ışınlarının girişimleri sonucu kırınım olayı oluşur (Şekil 4.2).



Şekil 4.2. X-ışınlarının bir kristalin düzlemlerinden kırınımı.

Şekilde görülen yansıma esnasında x-ışınlarının esnek olarak saçıldığı varsayılmıştır. D ve B noktalarından yansıyan ışınlar arasındaki yol farkı $AB+BC=2dSin\theta$ kadardır. Eğer bu yol farkı, dalga boyunun tam katları ise, şekil 4.2'de görüldüğü gibi yapıcı girişim, diğer durumlarda ise, yıkıcı girişim meydana gelir. Böylece Bragg yasası

$$2dSin\theta = n\lambda \tag{4.1}$$

şeklinde yazılır. Bragg yasasının geçerli olabilmesi için $\lambda \leq 2d$ koşulu sağlanmalıdır.

4.2.2. X-ışını Toz Kırınım Analizi

X-ışını toz kırınım analizinde, verilen örneğe ait x-ışını toz kırınım deseni kullanılır. Bu desen saçılma açılarından ($2\theta_i$) ve bu açılarda ölçülen sayım değerlerinden (y_i^d) oluşur. Başlangıç noktası $2\theta_b$ 'den başlayan $2\theta_i$ değerleri,

$$2\theta_i = 2\theta_b + (i-1) \qquad \text{ADIM} \tag{4.2}$$

şeklinde ADIM büyüklüğüne bağlı olarak adım adım atar. Her $2\theta_i$ konumuna bağlı gelen sayım değerleri deneysel yollarla ölçülür. Bu sayede x-ışını toz kırınım deseni elde edilmiş olur. Adım büyüklüğünün değeri laboratuarlarda kullanılan x-ışını toz difraktometreleri için 0.005° ile 0.05° arasında olabilir. Herhangi bir $2\theta_i$ konumunda hesaplanan sayım

$$y_i^h = y_{bi} + s \sum_k I_k \Omega(x_{i,k})$$
 (4.3)

$$x_{i,k} = 2\theta_i - 2\theta_k \tag{4.4}$$

$$I_k = L_k A_k P_k \left| F_k \right|^2 \tag{4.5}$$

şeklinde verilir. Burada y_{bi} taban sayımı, *s* skala faktörü, $\Omega(x)$ pik fonksiyonu, *k* Miller indisleri, P_k tercihli yönelim fonksiyonu, L_k Lorentz ve kutuplanma düzeltmesi ile çokluk çarpanını içeren katsayı, I_k şiddet ve A_k asimetri fonksiyonudur [11].

4.2.3. X-ışını Toz Kırınım Ölçümleri

Külçe şeklinde elde edilen örnekler, agat havanda öğütülüp toz haline getirilerek x-ışını toz difraktometresinde $15^{\circ} \le 20 \le 80^{\circ}$ olmak üzere incelenmişlerdir. Elde edilen verilerin x-ışını toz kırınım analizleri, FULLPROF programı ile yapılmıştır. Bu analizler ile elde edilen örneklerde yabancı fazlar kontrol edilmiş ve ciddi bir safsızlık gözlenmemiştir. Toz kırınım desenleri *P6/mmm* uzay grubuna göre indislenerek, hekzagonal örgü parametreleri *a* ve *c* duyarlı bir şekilde bulunmuştur. Bu deneylerde Bruker D8 Advance x-ışını toz difraktometresi kullanılmıştır.

4.3. Mıknatıslanma Ölçümleri

Mıknatıslanma ölçümleri için 5 Tesla üstüniletken manyete sahip SQUID (Superconducting Quantum Interference Devices) manyetometre [47] kullanılmıştır (Şekil 4.3).



Şekil 4.3. SQUID (Superconducting Quantum Interference Devices) manyetometre.

SQUID sisteminde üstün iletken durumundaki algılama kanalı sıvı helyum içindedir. Algılama kanalı içinde sabit hızla hareket eden örneğin bulunduğu konuma göre gerilim değerleri SQUID algılayıcı sayesinde ölçülür. Konuma göre ölçülen bu gerilim değerlerinden şekil 4.5'deki gibi bir eğri elde edilir. İstenilen sıcaklık ve manyetik alan değerinde, mıknatıslanması bilinen bir örnek kullanılarak bu işlem yapılır ve eğrinin tepe noktasındaki gerilim değeri bulunur. Bu gerilim değeri, örneğin mıknatıslanmasına eşitlenerek kalibrasyon katsayısı bulunur. Artık istenilen örnekler için bulunan tepe noktasındaki gerilim değerleri de bu kalibrasyon katsayısı ile çarpılarak mıknatıslanma



Şekil 4.4. Mıknatıslanma ölçümlerinde kullanılan SQUID gerilimi - örnek konumu grafiği.

Kullanılan SQUID'in duyarlılığı 10^{-8} emu'dur. Doğru ölçüm yapabilmek için merkezleme işleminin hassas bir şekilde yapılması gerekir. Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğinin oda sıcaklığı altında 4 K ile 400 K aralığında mıknatıslanma ölçümleri SQUID manyetometre kullanılarak yapılmıştır.

5. BÖLÜM

SONUÇ VE TARTIŞMA

Şekil 5.1'de görülen x-ışını toz kırınım analizi, *P6/mmm* uzay grubunda kristalleşen hekzagonal Ce₃Co₁₁B₄-tipi yapıya sahip bileşikte, ana faz ve az miktarda yabancı fazın olduğunu göstermektedir. FULLPROF [48] programı ile standart profil eşleştirme yöntemi kullanılarak oda sıcaklığındaki örgü parametreleri a = 5.0498 Å ve c = 9.8988Å olarak bulunmuştur. Örgü parametrelerinin değerleri beklendiği gibi Ce₃Co₁₁B₄ ve Gd₃Co₁₁B₄ bileşikleri için elde edilen değerlerin arasındadır [49-51].



Şekil 5.1. Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğinin x-ışını toz kırınım analizi.

Şekil 5.2 Ce₂GdCo₁₁B₄ numunesi için uygulanan 1 T alan altında mıknatıslanmanın sıcaklığa bağımlılığını göstermektedir. 301 K'de *M-T* eğrisindeki büyük düşüş ferrimanyetikten paramanyetik faza geçişe tekabül etmektedir. Bileşiğin $T_{\rm C}$ 'si dM/dT'nin en düşük değerine ulaştığı sıcaklık olarak tanımlanır. *R* altörgüsünün manyetik momenti Co altörgüsünün manyetik momentinden artan sıcaklıkla hızla azaldığından, $T_{\rm den}$ = 40 K'de görülen dengelenme noktasını verir. Daha düşük sıcaklıklarda Co alt-örgü momenti *R* alt-örgü momentini iptal edebilir, zira Gd'un Ce ile

değiştirilmesi nadir toprak alt-örgüsünün manyetik momentini güçlü şekilde zayıflatır. Bu nedenle, $Ce_2GdCo_{11}B_4$ bileşiğinin dengelenme sıcaklığı $Gd_3Co_{11}B_4$ bileşiğininkinden çok daha düşüktür.



Şekil 5.2. Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğine ait 1 T manyetik alan altındaki mıknatıslanmanın sıcaklığa bağlı grafiği.

4 K'deki $M_{\rm S}$ (1.58 $\mu_{\rm B}$) doyum mıknatıslanması *M*–*H* eğrisinin yüksek alanlı kısmından türetilmiştir. 4 K'deki dış manyetik alana bağlı mıknatıslanma eğrisi Şekil 5.3'te gösterilmiştir.



Şekil 5.3. Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğinin 4 K'deki dış manyetik alana bağlı mıknatıslanma grafiği.

Şekil 5.4, Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğinin 5 T'ya kadar olan manyetik alanlar altında Curie sıcaklıkları civarında ölçülen mıknatıslanma değerlerini göstermektedir.



Şekil 5.4. Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğinin Curie sıcaklığı yakınlarında 5 T manyetik alana kadar mıknatıslanma ölçümleri.

Mıknatıslanmanın izotermal süreci sırasında, malzemelerin manyetik entropi değişimi, H manyetik alanı üzerinden M mıknatıslanmanın integralinin alındığı Maxwell bağıntısından elde edilebilir:

$$\Delta S_m(T,H) = S_m(T,H) - S_m(T,0) = \int_0^H \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H dH$$
(5.1)

 ΔS_m manyetik entropi değişiminin sıcaklığa bağımlılığını elde etmek için, genellikle denklem 5.1'deki integralin aşağıdaki nümerik yaklaşımı uygulanır:

$$|\Delta S_{m}| = \sum_{i} \frac{M_{i} - M_{i+1}}{T_{i+1} - T_{i}} \Delta H$$
(5.2)

burada M_i ve M_{i+1} , sırasıyla uygulanan H manyetik alanında T_i ve T_{i+1} 'de ölçülen mıknatıslanmanın deneysel verileridir. Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiği için alan varyasyonu ile ilişkili ΔS_m , denklem 5.2'ye göre hesaplanabilir. Şekil 5.5, Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiği için ΔS_m manyetik entropi değişiminin sıcaklığa bağımlılığını göstermektedir. Beklendiği gibi, maksimum entropi Curie sıcaklığı etrafında gözlenmiştir. Uygulanan manyetik alanın artmasıyla ΔS_m gözle görülür biçimde artmaktadır. Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiği için maksimum ΔS_m değeri 0–5 T'lik bir alan değişimi için 0.306 Jkg⁻¹K⁻¹'e ulaşır.



Şekil 5.5. Çeşitli manyetik alanlarda Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğinin manyetik entropi değişimi.

Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiği için 0 T'dan 5 T'ya kadar artan alanda Arrott çizimleri (M^2 ve H/M eğrileri) şekil 5.6'da gösterilmiştir. Arrott çizimi T_C Curie sıcaklığı yakınında hemen hemen doğrusaldır. Tüm Arrott çizimleri, ferrimanyetik ve paramanyetik fazlar arasındaki geçişin Banerjee kriterine göre ikinci dereceden olduğunu gösteren pozitif eğim sergilemektedir [52].



Şekil 5.6. Çeşitli sıcaklıklarda Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğinin Arrott çizimleri.

Genel olarak, manyetik faz geçişlerinin çoğu ikinci derecedendir. İkinci dereceden manyetik faz geçişleri olan malzemeler birinci derece manyetik faz geçişlerine kıyasla daha az manyetokalorik etki sergilemektedir [53,54]. Ce₂GdCo₁₁B₄ numunesindeki manyetik entropi değişiminin küçük değeri ikinci derece manyetik faz geçişi ve doyum mıknatıslanmanın küçük değeri ile yakından ilişkilidir.

Sonuç olarak, Ce₃Co₁₁B₄-tip hekzagonal yapılı Ce₂GdCo₁₁B₄ bileşiğinin manyetokalorik etkisi incelenmiştir. Ferrimanyetik–paramanyetik geçiş sıcaklığı 1 T'lık uygulanan bir manyetik alan altında 301 K'dir. Ce₂GdCo₁₁B₄'nin $|\Delta S_{max}|$ maksimum manyetik entropi değişimi 5 T'lık bir alan değişimi için 0.306 Jkg⁻¹K⁻¹'e eşittir. Arrott çizimleri ferrimanyetikten paramanyetiğe doğru olan manyetik faz geçiş türünün ikinci dereceden olduğunu göstermektedir. Manyetik entropi değişiminin küçük değeri, doyum mıknatıslanmasının küçük değeri ve ikinci derece faz geçişi olarak yorumlanır [55].
KAYNAKLAR

- Warburg, E., Magnetische Untersuchungen, Annalen der Physik(Leipzig), 249: 141-146, 1881.
- Debye, P., Einige Bemerkungen zur Magnetisierung beitiefer temperatur, Annalen der Physik, 386:1154-1160, 1926.
- Giauque, W.F., A thermodynamic treatment of certain magnetic effects. A proposed method of producing temperatures considerably below 1° absolute, J. Amer. Chem. Soc., 49:1864–1870, 1927.
- Giauque, W.F., MacDougall, D.P., Attainment of temperatures below 1° absolute by demagnetization of Gd₂(SO₄)₃ 8H₂O, Phys. Rev., 43:768-768, 1933.
- Gschneidner Jr., K.A., Pecharsky, V.K., Tsokol, A.O., Recent developments in magnetocaloric materials, Rep. Prog. Phys., 68:1482-1533, 2005.
- 6. Kuzma, Yu.B., Bilonizhko, N.S., Sov. Phys. Crystallogr., 18:447, 1974.
- Smit, H.H.A., Theil, R.C., Buschow, K.H.J. J., Phys. F: Met. Phys., 18:295, 1988.
- Kowalczky, A., Stefanski, P., Crystallographic And Magnetic-Properties Of R3co11b4 (R=Y And Gd) Compounds, IEEE Trans. Magn., 30:648-650, 1994.
- **9.** Galatanu, A., et al., Effect of aluminium on phase stability in the Gd₃Co₁₁(B,A1)₄ system, J. Alloys Compd., 262-263:356-362, 1997.
- Ido, H., Yamaguchi, Y., Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 487:272-276, 2004.
- **11.** Kervan, S., R_{1-x}R'_xMn₂Ge₂ İntermetalik Bileşiklerin Kristal Yapı ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2001.
- Gignoux, D., Schlenker, M., Magnetism. Vol. 1, Fundamentals (ISBN 0387229671), 532:79-84, 2005.
- Merida, W., Hall, J., et. al., IESVic/Cryofuel Systems, University of Victoria, http://www.mech.ubc.ca/FCH2/Publications/MagneticRefrigeration.pdf #search=%22W.%20Merida%2C%20J.%20Hall%22.
- Gould, H., Tobochnik, J., Thermal and Statistical Physics, Princeton University Press, 39:50-52, 67, 2006.

- **15.** Ağıl, H., Bor Esaslı İntermetalik Bileşiklerin Manyetik, Yapısal Ve Termal Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2008.
- Swalin, R.A., Thermodynamics of Solids (New York: Wiley), 23:131-140, 1962.
- 17. Bazarov, I.P., Thermodynamics (Oxford, New York: Pergamon Press), 1964.
- Vonsovskii, S.V., Magnetism (Jerusalem: Israel Program Sci. Translations), 1974.
- 19. Kittel, C., Elementary Statistical Physics (New York: Wiley), 1958.
- 20. Belov, K.P., Magnetic Transformations (New York: Consultants Bureau), 1961
- Smart, J.S., Effective Field Theories of Magnetism (Philadelphia, London:WB Saunders), 1966.
- **22.** Kuz'min, M.D., Tishin, A.M., Magnetocaloric effect. Part 1: An introduction to various aspects of theory and practice, Cryogenics 32:545-558, 1992.
- **23.** Tishin, A.M., Magnetocaloric effect in strong magnetic fields, Cryogenics, 30:127-136, 1990.
- 24. Ikeda, K., et al., Solid State Commun, 51:943-945, 1982.
- **25.** Grewe, N., Steglich, F., Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earthed K A Gschneidner Jr and L Eyring (Amsterdam: Elsevier) 14:343, 1991.
- 26. Stewart, G.R., Rev. Mod. Phys., 56:755-787, 1984.
- Gopal, E.S.R., Specific Heats at Low Temperatures (New York: Plenum Press), 1966.
- 28. Kittel, C., Thermal Physics (New York: Wiley), 1969.
- 29. Pecharsky, V.K., Gd₅(Si_xGe_{1-x})₄: An Extremum Material Gschneidner, K.A., Adv. Mater., 13:683-686, 2001.
- **30.** Tishin, A.M., Magnetocaloric effect in lanthanide materials, Journal of Alloys and Compounds, 250:635-641, 1997.
- Oesterreicher, H., Parker, F.T., Magnetic cooling near Curie temperatures above 300 K, J. Appl. Phys., 55:4334, 1984.
- **32.** Bennett, L.H., et al., The magnetocaloric effect: The role of magnetic anisotropy, J. Appl. Phys., 73:6507, 1993.
- Druzhinin, V.V., Melnikov, V., Shkarubski, V.V., Sov. Phys.–Solid State, 21:1002, 1979.

- 34. Hashimoto T, et al., Magnetic refrigeration in the temperature range from 10 K to room temperature: the ferromagnetic refrigerants, Cryogenics, 21:647-653, 1981.
- **35.** Taylor, K.N.R., Darby, M.I., Physics of Rare Earth Solids (London: Chapman and Hall), 1972.
- Druzhinin V.V., Ponomarev, B.K., Zapasski S.P., Sov. Phys.–Solid State 19:25, 1977.
- McMichael, R.D., Ritter, J.J., Shull, R.D., Enhanced magnetocaloric effect in Gd₃Ga_{5-x}Fe_xO₁₂, J. Appl. Phys., 73:6946, 1993.
- Foldeaki, M., Chahine, R., Bose, T.K., Magnetic measurements: A powerful tool in magnetic refrigerator design, J. Appl. Phys., 77:3528, 1995.
- **39.** Dan'kov, S.Yu., Spichkin, Yu., Tishin A.M., Journal of Magnetism and Magnetic Materials, J. Magn. Magn. Mater., 152:208-212, 1996.
- **40.** Pecharsky, V.K., Gschneidner, K.A., Magnetocaloric effect from indirect measurements: Magnetization and heat capacity, J. Appl. Phys., 86:565, 1999.
- 41. Giguere, A., et al., Phys. Rev. Lett., 83:2262, 1999.
- 42. Sun, J.R., Hu, F.X., Shen, B.G., Phys. Rev. Lett., 85:4191, 2000.
- 43. Gschneidner, K.A., et al., Phys. Rev. Lett. 85:4190, 2000.
- 44. Wada, H., et al., Magnetocaloric effects of Laves phase Er(Co_{1-x}Ni_x)₂ compounds, J. All. Comp., 316:245-249, 2001.
- **45.** Foldeaki, M., et al., Comparison of magnetocaloric properties from magnetic and thermal measurements, J. Appl. Phys. 82:309, 1997.
- **46.** Giacovazzo, G., et al., Fundamentals of Crystallography. IUCr, Oxford University Press, New York, 1992.
- 47. McElfresh, M., Fundementals of Magnetism and Magnetic Measurements: Featuring Quantum Design's Magnetic Property Measurement System. Ouantum Design, San Diago, 1994.
- **48.** Rodriguez-Carvajal, J., Recent advances in magnetic structure determination by neutron powder diffraction, Physica B 192:55-69, 1993.
- 49. Smit, H.H.A., et al., J. Phys. F: Met. Phys. 18:295, 1988.
- 50. Kowalczky, A., Stefanski, P., Crystallographic and magnetic properties of R₃Co₁₁ B₄(R=Y and Gd) compounds, IEEE Trans. Magn., 30:648-650, 1994.

- **51.** Galatanu, A., et al., Effect of aluminium on phase stability in the Gd₃Co₁₁(B,A1)₄ system, AlloysCompd., 262/263:356-362, 1997.
- **52.** Banerjee, S.K., On a generalised approach to first and second order magnetic transitions, Phys. Lett., 12:16-17, 1964.
- 53. Brück, E., et al., Magnetocaloric refrigeration near room temperature (invited), Magn. Magn. Mater., 310:2793-2799, 2007.
- 54. Gschneidner Jr., K.A., Pecharsky, V.K., Thirty years of near room temperature magnetic cooling: Where we are today and future prospects, Int. J. Ref. 31:945-961, 2008.
- 55. Kervan, N., et al, Magnetic properties and magnetocaloric effect of Ce₂GdCo₁₁B₄ boride, Materials Chemistry and Physics, 116:586-588, 2009

ÖZGEÇMİŞ

Durmuş Serkan SÜTSEVER 1979 yılında Nevşehir' de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir' de tamamladı. 1996 yılında kazandığı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl Konya' da öğretmenlik görevine başladı. Evli ve üç çocuk babası olup halen Nevşehir H. Avni İncekara Fen Lisesinde Fizik Öğretmeni olarak görevine devam etmektedir.

Adres: Güzelyurt Mahallesi Duygulu Sokak No:23/3 50300 NEVŞEHİR
Telefon: 0505 661 28 27
e-posta: dssutsever@hotmail.com